

日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2001年 7月 2日
Date of Application:

出願番号 特願2001-201513
Application Number:
ST. 10/C]: [JP2001-201513]

願人 古河電気工業株式会社
Applicant(s):

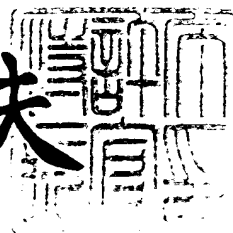
BEST AVAILABLE COPY

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 1月13日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 A10073

【提出日】 平成13年 7月 2日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01S 3/18

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 築地 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 吉田 順自

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 船橋 政樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 木村 俊雄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 愛清 武

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 清水 健男

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 山本 敏郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 虎谷 智明

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 松浦 寛

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 小西 美恵子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 中江 将士

【特許出願人】

【識別番号】 000005290

【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社

【代表者】 古河 潤之助

【代理人】

【識別番号】 100096035

【弁理士】

【氏名又は名称】 中澤 昭彦

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-381936

【出願日】 平成12年12月15日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-323118

【出願日】 平成12年10月23日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043351

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9801417

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体レーザモジュール及びその製造方法並びに光増幅器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

間隔を隔てて形成された複数のストライプを有し、前記各ストライプの一方側端面からそれぞれレーザ光を出射し、各ストライプに回折格子が設けられている半導体レーザ素子と、

前記半導体レーザ素子から出射された複数のレーザ光を受光し、それぞれストライプの並び方向に分離する第 1 レンズと、

その第 1 レンズを通過した複数のレーザ光を光合成する光合成手段と、

その光合成手段から出射されるレーザ光を受光し外部に送出する光ファイバと

を有することを特徴とする半導体レーザモジュール。

【請求項 2】

隣接するストライプ同士の間隔が $100\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 3】

前記半導体レーザ素子の回折格子は、レーザ光の出射端面に設けた第 1 反射膜と、そのレーザ光の反射端面に設けた第 2 反射膜との間に形成された活性層の近傍に設けられ、

前記活性層が形成する共振器長と前記回折格子の波長選択特性とを含む発振パラメータの組み合わせ設定によって発振波長スペクトルの半値幅内に 2 本以上の発振縦モードを含むレーザ光を出力することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 4】

半導体レーザ素子から出力されるレーザ光の発振波長が $1300\sim 1550\text{nm}$ であることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 5】

前記発振波長スペクトルの半値幅は、3 nm以下であることを特徴とする請求項3又は4に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項6】

前記半導体レーザ素子の活性層が形成する共振器長は、800 μ m以上であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項7】

前記半導体レーザ素子の活性層が形成する共振器長は、3200 μ m以下であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項8】

前記回折格子は、グレーティング周期に所定の周期揺らぎを持たせたことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項9】

前記回折格子は、前記グレーティング周期をランダム又は所定周期で変化させたグレーティングであることを特徴とする請求項8に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項10】

前記回折格子は、前記半導体レーザ素子の活性層に沿って、前記共振器長と同じ長さを有することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項11】

前記回折格子は、前記半導体レーザ素子の活性層に沿った一部に設けられることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項12】

前記回折格子は、レーザ光の前記第1反射膜近傍から前記第2反射膜側方向にあるいは前記第2反射膜近傍から前記第1反射膜側方向に、前記活性層に沿って一定長延びた部分回折格子であることを特徴とする請求項11に記載の半導体レ

ーザモジュール。

【請求項 13】

前記発振パラメータは、前記回折格子の結合係数を含むことを特徴とする請求項 3 乃至 12 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 14】

前記半導体レーザ素子と光ファイバとの間に、光ファイバ側からの反射戻り光の入射を抑制する光アイソレータが設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至 13 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 15】

前記各ストライプに設けられた回折格子で選択される波長が実質的に等しいことを特徴とする請求項 1 乃至 14 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 16】

前記各ストライプに設けられた回折格子で選択される波長がわずかにずれていることを特徴とする請求項 1 乃至 14 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 17】

前記波長のずれは、0.1 以上 3 nm 未満であることを特徴とする請求項 16 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 18】

前記各ストライプに設けられた回折格子で選択される波長がずれていることを特徴とする請求項 1 乃至 14 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 19】

前記波長のずれは、3 nm 以上であることを特徴とする請求項 18 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 20】

前記半導体レーザ素子の各ストライプを電氣的に絶縁し、それぞれ独立に駆動させることを特徴とする請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レ

ーザモジュール。

【請求項 2 1】

前記光ファイバは、偏波保存ファイバであり、かつその偏波面が半導体レーザー素子の偏波面と 45 度ずれて結合されることを特徴とする請求項 1 乃至 18 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザーモジュール。

【請求項 2 2】

前記光合成手段は、前記第 1 レンズを通過したそれぞれの光の進行方向を同一方向にするプリズムを含むことを特徴とする請求項 1 乃至 21 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザーモジュール。

【請求項 2 3】

前記光合成手段は、第 1 レンズを通過した複数の光をそれぞれ異なる入力部から入力して合成して単一の出力部から出力する複屈折素子を含むことを特徴とする請求項 1 乃至 22 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザーモジュール。

【請求項 2 4】

第 1 ～ n (n は 2 以上の整数) のストライプからそれぞれ第 1 ～ 第 n 波長の光を出射し、

前記光合成手段は、第 1 ～ 第 n 波長の光をそれぞれ入射する第 1 ～ 第 n 入力部と、光を全反射する反射部と、出力部とを備えたものであり、

各第 i (i は 2 ～ n の全ての整数) 入力部と反射部は、第 $i - 1$ 入力部から光合成手段内に入射した第 $i - 1$ 光が反射部において第 i 入力部に向かって反射され、第 i 入力部において第 i 波長の光の進行方向に反射されて、第 i 波長の光と合成されるように構成され、

合成された第 1 ～ 第 n 波長の光が出力部を介して光ファイバに結合されることを特徴とする請求項 1 乃至 23 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザーモジュール。

【請求項 2 5】

前記請求項 1 乃至 24 のいずれか 1 つの項に記載の半導体レーザーモジュールを光増幅用の励起光源として用いていることを特徴とする光増幅器。

【請求項 2 6】

前記励起光源は、ラマン増幅に用いられることを特徴とする請求項 2 5 に記載の光増幅器。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体レーザモジュール及びその半導体レーザモジュールを用いた光増幅器に関し、特に、2つのレーザ光を出射させる2つのストライプを備えた半導体レーザ素子を用いた半導体レーザモジュール及び光増幅器に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年における高密度波長分割多重伝送方式による光通信の進展に伴い、光増幅器に使用される励起光源に対する高出力化の要求がますます高まっている。

【 0 0 0 3 】

また、最近では、光増幅器として従来より使用されてきたエルビウムドープ光増幅器よりも更に広帯域の光を増幅する手段としてラマン増幅器に対する期待が高まっている。ラマン増幅は、光ファイバに励起光を入射したときに発生する誘導ラマン散乱により、励起光波長から約 1 3 T H z 低周波側に利得が現れ、このように励起された状態の光ファイバに、上記利得を有する波長帯域の信号光を入力すると、その信号光が増幅されるという現象を利用した光信号の増幅方法である。

【 0 0 0 4 】

ラマン増幅においては、信号光と励起光（ポンプ光）の偏波方向が一致している状態で信号光が増幅されるので、信号光と励起光との偏光面のずれの影響を極力小さくする必要がある。そのため、励起光の偏波を解消（非偏光化：デポラライズ）して、偏光度（DOP : Degree Of Polarization）を低減させることが行われている。

【 0 0 0 5 】

このように、励起光源の高出力化及び無偏光化を同時に実現する方法として、例えば米国特許第 5 5 8 9 6 8 4 号公報に開示されているように、同一波長で発

振する 2 つの半導体レーザモジュールから出射されたレーザ光を偏波合成カプラにより偏波合成する方法が知られている。

【0 0 0 6】

図 3 5 は、米国特許第 5 5 8 9 6 8 4 号公報に開示された従来の半導体レーザ装置を説明するための説明図である。

【0 0 0 7】

図 3 5 に示すように、従来の半導体レーザ装置は、同一波長で互いに直交する方向にレーザ光を出射する第 1 の半導体レーザ素子 1 0 0 及び第 2 の半導体レーザ素子 1 0 1 と、第 1 の半導体レーザ素子 1 0 0 から出射されたレーザ光を平行にする第 1 の平行レンズ 1 0 2 と、第 2 の半導体レーザ素子 1 0 1 から出射されたレーザ光を平行にする第 2 の平行レンズ 1 0 3 と、第 1 の平行レンズ 1 0 2 及び第 2 の平行レンズ 1 0 3 によって平行になったレーザ光を直交偏波合成する偏波合成カプラ 1 0 4 と、偏波合成カプラ 1 0 4 によって偏波合成されたレーザ光を集光する集光レンズ 1 0 5 と、集光レンズ 1 0 5 によって集光されたレーザ光が入射され外部に送出するファイバブラッググレーティング (F B G) 1 0 6 付き光ファイバ 1 0 7 とを有する。

【0 0 0 8】

従来の半導体レーザ装置によれば、第 1 の半導体レーザ素子 1 0 0 及び第 2 の半導体レーザ素子 1 0 1 から互いに直交する方向に出射されたレーザ光が偏波合成カプラ 1 0 4 によって偏波合成されるので、光ファイバ 1 0 7 からは偏光度の小さいレーザ光を出射することができる。また、光ファイバ 1 0 7 にファイバブラッググレーティング 1 0 6 が形成されているので、半導体レーザ素子 1 0 0、1 0 1 の発振波長が同一波長に固定され、光ファイバ 1 0 7 から波長が固定されたレーザ光を出射することができる。

【0 0 0 9】

従って、上記の従来の半導体レーザ装置は、高い光出力が要求される光増幅器の励起光源、とりわけ低偏波依存性及び波長安定性が要求されるラマン増幅器の励起光源として適用することが可能である。

【0 0 1 0】

【発明が解決しようとする課題】

従来の半導体レーザ装置には、次のような課題があった。

(1) 従来の半導体レーザ装置では、2個の半導体レーザ素子100, 101をそれぞれ取り付けた2個のチップキャリアを基台上に半田付けして配置する必要がある。このとき、2個の半導体レーザ素子100, 101から出射されるレーザ光が互いに直交するように位置決めする必要があるため、半導体レーザ素子の位置決め時間が長くなる。その結果、半導体レーザモジュールの製造時間が長くなる。

【0011】

(2) 各半導体レーザ素子100, 101からの出射光が互いに全く異方向に出射されるため、高温状態において光学部品を調芯固定したパッケージの反り等の影響により、光ファイバから出射される光の光強度及び偏光度を安定化させることが困難である。

【0012】

(3) 従来の半導体レーザ装置では、半導体レーザ素子100から出射されたレーザ光を平行にする平行レンズ102, 103を用いているので、ビーム径及び像倍率が大きくなり、位置や角度のトレランスが厳しいという課題があった。

【0013】

(4) 間隔が離れた2つの半導体レーザ素子100, 101を冷却するためには大型のペルチェモジュールを必要とする。その結果、半導体レーザモジュールの消費電力がアップするという課題があった。

【0014】

(5) 従来の半導体レーザ装置は、ファイバグレーティング106を有した光ファイバと、半導体レーザ素子100, 101とを光結合する必要がある、共振器内における機械的な光結合であるために、レーザの発振特性が機械的振動などによって変化してしまうおそれがあり、安定した光出力を提供することができない場合が生じるという問題点があった。

【0015】

また、この半導体レーザ装置をラマン増幅用励起光源ととらえると、次のよう

な課題がある。

【0016】

(6) 各ストライプから出射されるレーザ光の波長は、1つのFBGによって決定されてしまい、各ストライプの波長設定の自由度がなかった。ラマン増幅器では、例えば波長1430nmと1450nmの励起光を合成して、ゲインスペクトルの平均化を図るようなことが行われるが、従来は、2個の半導体レーザを使用する必要があった。

【0017】

(7) 従来の半導体レーザ装置では、半導体レーザ素子100、101と、ファイバグレーディング106との間隔が長いため、ファイバグレーディング106と光反射面との間の共振によって相対強度雑音(RIN:Relative Intensity Noise)が大きくなる。例えば、ラマン増幅では増幅の生じる過程が早く起こるため、励起光強度が揺らいでいると、ラマン利得も揺らぐことになり、このラマン利得の揺らぎがそのまま増幅された信号強度の揺らぎとして出力されてしまい、安定したラマン増幅を行わせることができないという問題点があった。

【0018】

(8) 光増幅方式としては、信号光に対して後方から励起する後方励起方式のほかに、信号光に対して前方から励起する前方励起方式および双方向から励起する双方向励起方式がある。現在、ラマン増幅器として多用されているのは、後方励起方式である。その理由は、弱い信号光が強い励起光とともに同方向に進行する前方励起方式では、励起光強度の揺らぎが増幅された信号光の揺らぎに強く影響するという問題があるからである。したがって、前方励起方式にも適用できる安定した励起光源の出現が要望されている。すなわち、従来のファイバグレーディングを用いた半導体レーザモジュールを用いると、適用できる励起方式が制限されるという問題点があった。

【0019】

ラマン増幅器におけるラマン増幅では、信号光の偏波方向と励起光の偏波方向とが一致することを条件としている。すなわち、ラマン増幅では、増幅利得の偏波依存性があり、信号光の偏波方向と励起光の偏波方向とのずれによる影響を小

小さくする必要がある。ここで、後方励起方式の場合、信号光は、伝搬中に偏波がランダムとなるため、問題は生じないが、前方励起方式の場合、偏波依存性が強く、励起光の直交偏波合成、デボラライズなどによって偏波依存性を小さくする必要がある。すなわち、偏光度 (DOP: Degree Of Polarization) を小さくする必要がある。また、ラマン増幅は、得られる増幅率が比較的低いため、高出力のラマン増幅用励起光源の出現が望まれていた。

【0020】

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、安定し、高利得を得ることができる光増幅器用光源等に適した半導体レーザモジュール及びその半導体レーザモジュールを用いた光増幅器を提供することを目的とする。

【0021】

【課題を解決するための手段】

本発明の半導体レーザモジュールは、間隔を隔てて形成された複数のストライプを有し、前記各ストライプの一方側端面からそれぞれレーザ光を出射し、各ストライプに回折格子が設けられている半導体レーザ素子と、半導体レーザ素子から出射された複数のレーザ光を受光し、それぞれストライプの並び方向に分離する第1レンズと、その第1レンズを通過した複数のレーザ光を光合成する光合成手段と、その光合成手段から出射されるレーザ光を受光し外部に送出する光ファイバと、を有することを特徴とするものである。

【0022】

隣接するストライプ同士の間隔が $100\ \mu\text{m}$ 以下であるのが好ましい。

【0023】

前記半導体レーザ素子の回折格子は、レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と、そのレーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層の近傍に設けられ、前記活性層が形成する共振器長と前記回折格子の波長選択特性とを含む発振パラメータの組み合わせ設定によって発振波長スペクトルの半値幅内に2本以上の発振縦モードを含むレーザ光を出力してもよい。

【0024】

半導体レーザ素子から出力されるレーザ光の発振波長は例えば $1300\sim 15$

5 0 n mである。

【 0 0 2 5 】

前記発振波長スペクトルの半値幅は、例えば 3 n m以下である。

【 0 0 2 6 】

前記半導体レーザ素子の活性層が形成する共振器長は、例えば 8 0 0 μ m以上である。

【 0 0 2 7 】

前記半導体レーザ素子の活性層が形成する共振器長は、例えば 3 2 0 0 μ m以下である。

【 0 0 2 8 】

前記回折格子は、グレーティング周期に所定の周期揺らぎを持たせてもよい。

【 0 0 2 9 】

前記回折格子は、前記グレーティング周期をランダム又は所定周期で変化させたグレーティングであってもよい。

【 0 0 3 0 】

前記回折格子は、前記半導体レーザ素子の活性層に沿って、前記共振器長と同じ長さを有してもよい。

【 0 0 3 1 】

前記回折格子は、前記半導体レーザ素子の活性層に沿った一部に設けられてもよい。

【 0 0 3 2 】

前記回折格子は、レーザ光の前記第 1 反射膜近傍から前記第 2 反射膜側方向にあるいは前記第 2 反射膜近傍から前記第 1 反射膜側方向に、前記活性層に沿って一定長延びた部分回折格子であってもよい。

【 0 0 3 3 】

前記発振パラメータは、前記回折格子の結合係数を含んでもよい。

【 0 0 3 4 】

前記半導体レーザ素子と光ファイバとの間に、光ファイバ側からの反射戻り光の入射を抑制する光アイソレータが設けられていてもよい。

【0035】

前記各ストライプに設けられた回折格子で選択される波長が実質的に等しくてもよい。

【0036】

前記各ストライプに設けられた回折格子で選択される波長がわずかにずれていてもよい。この場合、前記波長のずれは、例えば0.1以上3nm未満である。

【0037】

前記各ストライプに設けられた回折格子で選択される波長がずれていてもよい。この場合、前記波長のずれは、例えば3nm以上である。

【0038】

前記半導体レーザ素子の各ストライプを電氣的に絶縁し、それぞれ独立に駆動させてもよい。

【0039】

前記光ファイバは、偏波保存ファイバであり、かつその偏波面が半導体レーザ素子の偏波面と45度ずれて結合されてもよい。

【0040】

前記光合成手段は、前記第1レンズを通過したそれぞれの光の進行方向を同一方向にするプリズムを含んでもよい。

【0041】

前記光合成手段は、第1レンズを通過した複数の光をそれぞれ異なる入力部から入力して合成して単一の出力部から出力する複屈折素子を含んでもよい。

【0042】

第1～n（nは2以上の整数）のストライプからそれぞれ第1～第n波長の光を出射し、前記光合成手段は、第1～第n波長の光をそれぞれ入射する第1～第n入力部と、光を全反射する反射部と、出力部とを備えたものであり、各第i（iは2～nの全ての整数）入力部と反射部は、第i-1入力部から光合成手段内に入射した第i-1光が反射部において第i入力部に向かって反射され、第i入力部において第i波長の光の進行方向に反射されて、第i波長の光と合成されるように構成され、合成された第1～第n波長の光が出力部を介して光ファイバに

結合されてもよい。

【0 0 4 3】

本発明の光増幅器は、前記半導体レーザモジュールを光増幅用の励起光源として用いていることを特徴とするものである。

【0 0 4 4】

前記励起光源は、ラマン増幅に用いられてもよい。

【0 0 4 5】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。

（第 1 の実施形態例）

図 1（A）は、本発明の第 1 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を示す側面断面図、図 2 は本発明の第 1 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0 0 4 6】

図 1（A）に示すように、本発明の第 1 の実施形態例に係る半導体レーザモジュール M 1 は、内部を気密封止したパッケージ 1 と、そのパッケージ 1 内に設けられ、レーザ光を出射する半導体レーザ素子 2 と、フォトダイオード（受光素子） 3 と、第 1 レンズ 4 と、プリズム 5 と、半波長板（偏光回転手段） 6 と、光合成部材（P B C：Polarization Beam Combiner） 7 と、光ファイバ 8 とを有する。

【0 0 4 7】

半導体レーザ素子 2 は、図 2 に示すように、間隔を隔てて長手方向に互いに同一平面上に平行に形成された第 1 のストライプ 9（ストライプ状発光部）及び第 2 のストライプ 1 0 を有し、第 1 のストライプ 9 及び第 2 のストライプ 1 0 の端面からそれぞれ第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 を出射する。図 2 中に示す K 1 及び K 2 は、それぞれ第 1 のストライプ 9 及び第 2 のストライプ 1 0 から出射されるビームの中心の軌跡を示す。ビームは、図 2 に破線で示すように、この中心のまわりにある広がりをもって伝搬する。第 1 のストライプ 9 と第 2 のストライプ 1 0 との間隔は、それぞれから出射された光 K 1、K 2 を 1 つの第

1 レンズ 4 に入射させるために、 $100\mu\text{m}$ 以下、例えば約 $40\mu\text{m}$ 程度に設定される。また、ストライプ同士の間隔が狭いことにより、ストライプ同士の光出力特性の差が小さくなる。

【0048】

図 1 (A) に示すように、半導体レーザ素子 2 はチップキャリア 11 上に固定して取り付けられる。なお、半導体レーザ素子 2 は、2 つのレーザ光 K 1, K 2 を出射するため、1 つのレーザ光を出射する半導体レーザ素子に比べて発熱しやすい。そこで、半導体レーザ素子 2 の放熱性を高めるため、図 1 (B) に示すように、半導体レーザ素子 2 は、ダイヤモンド等の熱伝導率の良好な材質で作られたヒートシンク 58 上に固定して取り付けられ、そのヒートシンク 58 がチップキャリア 11 上に固定して取り付けられていることが好ましい。

【0049】

フォトダイオード 3 は、半導体レーザ素子 2 の後側 (図 1 (A) では左側) 端面 2 b (図 2 参照) から出射されたモニタ用のレーザ光を受光する。フォトダイオード 3 は、フォトダイオードキャリア 12 に固定して取り付けられている。

【0050】

第 1 レンズ 4 は、半導体レーザ素子 2 の前側 (図 1 (A) では右側) 端面 2 a (図 2 参照) から出射された第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 とが入射され、レーザ光 K 1, K 2 を交差させ、第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 との間隔をストライプ 9, 10 の並び方向に広げ、分離するように、それぞれの光を異なる焦点位置 (F 1, F 2) に集光させる作用をもつ (図 2 参照)。

【0051】

図 1 (A) に示すように、第 1 レンズ 4 は、第 1 のレンズ保持部材 13 によって保持されている。第 1 レンズ 4 は、第 1 のストライプ 9 から出射された第 1 のレーザ光 K 1 の光軸と第 2 のストライプ 10 から出射された第 2 のレーザ光 K 2 の光軸とが、第 1 レンズ 4 の中心軸を挟んで略対称になるように位置決めされるのが好ましい。これによって、第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 が、ともに収差の小さい領域である第 1 レンズ 4 の中心軸近傍を通過するため、レーザ光の波面の乱れが少なくなり、光ファイバ 8 との光結合効率が高くなる。その

結果、より高出力の半導体レーザモジュールM1が得られる。なお、球面収差の影響を抑えるためには、第1レンズ4は、球面収差が小さく光ファイバ8との結合効率が高くなる非球面レンズを用いるのが好ましい。

【0052】

プリズム5は、第1レンズ4と光合成部材7との間に配設され、入射された第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2を、互いの光軸を略平行にして出射する。プリズム5は、BK7（ホウケイ酸クラウンガラス）等の光学ガラスで作られている。第1レンズ4から非平行に伝搬する第1及び第2のレーザ光K1、K2の光軸が、プリズム5の屈折により平行とされるため、そのプリズム5の後方に配置される光合成部材7の作製が容易になるとともに、光合成部材7を小型化し半導体レーザモジュールM1を小型にすることが可能となる。

【0053】

図3（A）はプリズム5の構成を示す側面図、（B）はその平面図である。図3に示すように、プリズム5は、その全長L1が約1.0mmであり、平坦状に形成された入射面5aと、所定角度 α （ α は $3.2^\circ \pm 0.1^\circ$ ）に傾斜した出射面5bを有する。

【0054】

図2に示すように、半波長板6は、プリズム5を通過した第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2のうち、第1のレーザ光K1のみが入射され、入射された第1のレーザ光K1の偏光面を90度回転させる。第1レンズ4によって、第1、第2のレーザ光K1、K2が十分分離されることにより、半波長板6が配置しやすくなっている。

【0055】

光合成部材7は、第1のレーザ光K1が入射される第1の入力部7aと、第2のレーザ光K2が入射される第2の入力部7bと、第1の入力部7aから入射される第1のレーザ光K1と第2の入力部7bから入射される第2のレーザ光K2とが合波されて出射される出力部7cとを有する。光合成部材7は、例えば、第1のレーザ光K1を常光線として出力部7cに伝搬させるとともに、第2のレーザ光K2を異常光線として出力部7cに伝搬させる複屈折素子である。光合成部

材 7 は、複屈折素子の場合、複屈折率性が高くレーザ光間の分離幅を大きくとれるように、例えば TiO_2 （ルチル）で作られる。

【0056】

本実施形態例においてはプリズム 5、半波長板 6 及び光合成部材 7 を同一のホルダ部材 14 に固定した偏波合成モジュール 59 を用いている。図 4（A）は偏波合成モジュール 59 を示す平面図、（B）はその側面断面図、（C）はその正面図である。図 4 に示すように、偏波合成モジュール 59 のホルダ部材 14 は、YAG レーザ溶接に好適な材料（例えば SUS 403、304 等）で作られ、その全長 L_2 は約 7.0 mm であり、全体が略円柱状に形成されている。ホルダ部材 14 の内部には収容部 14a が形成され、その収容部 14a にプリズム 5、半波長板 6 及び光合成部材 7 がそれぞれ固定される。ホルダ部材 14 の上部は開口され、その下部は平坦状に形成されている。

【0057】

これによって、光合成部材 7 の第 1 の入力部 7a から入射する第 1 のレーザ光 K_1 及び第 2 の入力部 7b から入射する第 2 のレーザ光 K_2 をともに出力部 7c から出射するように、プリズム 5、光合成部材 7 の中心軸 C_1 周りの位置を調整することが非常に容易になる。

【0058】

このように、ホルダ部材 14 によって、これらの光部品を一体化しておく、ホルダ部材 14 を Z 軸方向に移動させるだけで、レーザ光 K_1 、 K_2 同士の XY 平面上における重なり合い具合を調節できる。

【0059】

図 2 に示すように、光ファイバ 8 は、光合成部材 7 の出力部 7c から出射されるレーザ光を受光し、パッケージ 1 の外部に送出する。光ファイバ 8 には、図 2 に示すように、所定の波長帯の光を反射する FBG（Fiber Bragg Grating：ファイバブラッググレーティング）からなる光反射部 15 が設けられている。この光反射部 15 によって、所定波長の光が半導体レーザ素子 2 に帰還され、半導体レーザ素子 2 の発振波長が固定されるとともに、発振スペクトル幅を狭くすることができる。従って、この半導体レーザモジュール M1 からの出射光を、波長合

成カプラ (WDM) により合波して、エルビウムドープ光増幅器やラマン増幅器の励起光源として用いた場合には、波長合成カプラの損失を低く抑えて高出力の合波光を得ることができるとともに、ラマン増幅器に使用した場合には、ラマン増幅の利得変動を抑えることができる。光反射部 15 は、例えばフェーズマスクを介して干渉縞となった紫外光を光ファイバ 8 のコア部に照射することによって周期的に屈折率の変化を生じさせて形成される。

【0060】

光合成部材 7 と光ファイバ 8 との間には、光合成部材 7 の出力部 7c から出射されるレーザ光を光ファイバ 8 に光結合させる第 2 レンズ 16 が配設されている。第 1 のレーザ光 K1 及び第 2 のレーザ光 K2 は、第 1 レンズ 4 と第 2 レンズ 16 との間で焦点 (F1、F2) を結ぶように第 1 レンズ 4 が位置合わせされている。これによって、第 1 のレーザ光 K1 及び第 2 のレーザ光 K2 が第 1 レンズ 4 を通過後、分離する (図 2 中の距離 D' が十分大きな値となる) ために必要な伝搬距離 L が短くなるため、半導体レーザモジュール M1 の光軸方向の長さを短くすることができる。その結果、例えば高温環境下における半導体レーザ素子 2 と光ファイバ 8 との光結合の経時安定性が優れた、信頼性の高い半導体レーザモジュール M1 を提供できる。

【0061】

図 1 に示すように、半導体レーザ素子 2 を固定したチップキャリア 11 と、フォトダイオード 3 を固定したフォトダイオードキャリア 12 とは、断面略 L 字形状の第 1 の基台 17 上に半田付けして固定される。第 1 の基台 17 は、半導体レーザ素子 2 の発熱に対する放熱性を高めるために CuW 系合金等で作られているのが好ましい。

【0062】

第 1 レンズ 4 を固定した第 1 のレンズ保持部材 13 と、プリズム 5、半波長板 6 及び光合成部材 7 をホルダ部材 14 に固定した偏波合成モジュール 59 とは、第 2 の基台 18 上にそれぞれ第 1 の支持部材 19a 及び第 2 の支持部材 19b を介して YAG レーザ溶接により固定される。このため第 2 の基台 18 は、溶接性の良好なステンレス鋼等で作られているのが好ましい。また、第 2 の基台 18 は

、第1の基台17の平坦部17a上に銀ろう付けして固定される。

【0063】

第1の基台17の下部にはペルチェ素子からなる冷却装置20が設けられている。半導体レーザ素子2からの発熱による温度上昇はチップキャリア11上に設けられたサーミスタ20aによって検出され、サーミスタ20aより検出された温度が一定温度になるように、冷却装置20が制御される。これによって、半導体レーザ素子2のレーザ出射を高出力化かつ安定化させることができる。

【0064】

パッケージ1の側部に形成されたフランジ部1aの内部には、光合成部材7を通過した光が入射する窓部1bと、レーザ光を集光する第2レンズ16が設けられている。第2レンズ16は、フランジ部1aの端部にYAGレーザ溶接により固定された第2のレンズ保持部材21によって保持され、第2のレンズ保持部材21の端部には金属製のスライドリング22がYAGレーザ溶接により固定される。

【0065】

光ファイバ8はフェルール23によって保持され、そのフェルール23は、スライドリング22の内部にYAGレーザ溶接により固定されている。

【0066】

次に、本発明の第1の実施形態例に係る半導体レーザモジュールM1の動作について説明する。

【0067】

図2に示すように、半導体レーザ素子2の第1のストライプ9及び第2のストライプ10の前側端面2aからそれぞれ出射された第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2は、第1レンズ4を通過し、交差した後、間隔が広がり十分分離された後、プリズム5に入射される。プリズム5に入射した時の第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2との間隔(D)は約 $460\mu\text{m}$ である。プリズム5によって第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2は平行となって出射し(両者の間隔は約 $500\mu\text{m}$ になる)、第1のレーザ光K1は半波長板6に入射され、偏光面を90度回転させた後、光合成部材7の第1の入力部7aに入射され、第2

のレーザ光 K 2 は光合成部材 7 の第 2 の入力部 7 b に入射される。

【0068】

光合成部材 7 では、第 1 の入力部 7 a から入射される第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 の入力部 7 b から入射される第 2 のレーザ光 K 2 とが合波されて出力部 7 c から出射される。

【0069】

光合成部材 7 から出射されたレーザ光は、第 2 レンズ 1 6 によって集光され、フェルル 2 3 によって保持された光ファイバ 8 の端面に入射され外部に送出される。また、光ファイバ 8 の光反射部 1 5 によってレーザ光の一部が反射され、反射された光は、半導体レーザ素子 2 に帰還され、半導体レーザ素子 2 と光反射部 1 5 との間で外部共振器が構成されるので、光反射部 1 5 によって決定される波長でのレーザ発振が可能となる。

【0070】

一方、半導体レーザ素子 2 の後側端面 2 b から出射されたモニタ用のレーザ光は、フォトダイオード 3 によって受光され、フォトダイオード 3 の受光量等を算出することにより半導体レーザ素子 2 の光出力等を調整する。

【0071】

本発明の第 1 の実施形態例に係る半導体レーザモジュール M 1 によれば、1 つの半導体レーザ素子 2 に $100\ \mu\text{m}$ 以下という狭い間隔で形成された第 1、第 2 のストライプ 9, 10 から偏光面のそろった第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 が出射され、第 1 レンズ 4 で十分分離された後、半波長板 6 によって第 1 のレーザ光 K 1 の偏光面が正確に 90° 回転される。すなわち、このときレーザ光 K 1、K 2 の偏光面は略完全に 90° となる。この状態で、光合成部材 7 によって第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 が偏波合成されるので、光ファイバ 8 からは高出力で、かつ偏光度の小さいレーザ光を出射することができる。また、光ファイバ 8 に F B G からなる光反射部 1 5 が形成されているので、光ファイバ 8 から波長が固定されたレーザ光を出射することができる。従って、上記の半導体レーザモジュール M 1 を、高出力が要求されるエルビウムドープ光増幅器や、さらに低偏波依存性及び波長安定性が要求されるラマン増幅器の励起光源

として適用することができる。

【0072】

また、2つのレーザ光を出射させる2つのストライプを備えた1個の半導体レーザ素子2と、レーザ光K1、K2両方を分離する単一の第1レンズ4を用いているので、半導体レーザ素子2や第1レンズ4の位置決め時間が短くなる。その結果、半導体レーザモジュールM1の製造時間を短縮化できる。

【0073】

また、従来は2つの半導体レーザ素子からそれぞれ全く異なる軸方向に光が出射されるため、それぞれの軸方向でのパッケージの反り等を考慮してモジュールを設計しなければ、環境温度の変化等によって生じたパッケージの反りによる光出力変動を抑制できなかった。これに対し、本実施形態例の構成によれば、1個の半導体レーザ素子2から出射される2つの光は略同じ方向に伝搬されるため、パッケージの反りの影響を1方向（図2中、Z方向）においてのみ抑制することにより、光ファイバ8から出射される光出力の安定化を図ることができる。

【0074】

また、1個の半導体レーザ素子2から2つの光を出射することにより、これら2つの光はパッケージの反り等に対して、光ファイバ8との結合効率が同じ傾向で変動する。従って、温度変動等があった場合でも光ファイバ8から出射される光の偏光度が安定化する。

【0075】

また、1つの半導体レーザ素子2を用いるので、半導体レーザ素子2から発生した熱を冷却するためのペルチェモジュール等の冷却装置20を小型化でき、低消費電力化を図ることができる。

【0076】

なお、パッケージ1内を真空にするか、封入ガスXeとすることにより、2つのストライプ9、10から発生する莫大な熱を冷却装置20で放熱する際に必要な消費電力を大幅に抑制することができ、好ましい。

【0077】

また、本実施形態例のように2つのレーザ光を出射するダブルストライプ型半

導体レーザモジュールにファイバブラッググレーティング (FBG) を形成した偏波保存ファイバを取り付けた場合、同じ FBG 半値幅を有し、1つのレーザ光を出射するシングルストライプ型半導体レーザモジュールに比べ、多くの縦モードをスペクトル幅内に含ませることができる。

【0078】

図5は、ダブルストライプ型半導体レーザモジュールM1において駆動電流2A（つまりストライプ1本あたり1A）を印加した時のスペクトルを示すグラフである。図5からわかるように、ダブルストライプ型半導体レーザモジュールM1では、5本の縦モードがスペクトル半値幅内に含まれる。一方、シングルストライプ型半導体レーザモジュールの場合、駆動電流1Aでスペクトル半値幅内に含まれる縦モードは3～4本である。

【0079】

偏波保存ファイバの場合、slow軸とfast軸で異なる屈折率を持つため、FBG部分で選択される波長が0.4nm程度異なる。そのため、各ストライプに対応したスペクトルは従来と同じであっても、その重ね合わせとして得られるスペクトルのモード本数が増加したと考えられる。従って、本実施形態例のダブルストライプ型半導体レーザモジュールは、より効果的にDOP (Degree Of Polarization：偏光度) を低減でき、低偏波依存性が要求されるラマン増幅器の励起光源として好適である。

【0080】

さらに、ダブルストライプ型半導体レーザモジュールの場合、高い光出力を得ることができる。図6は、ダブルストライプ型半導体レーザモジュールにおいてLD駆動電流に対するファイバ出力を示すグラフである。図6からわかるように、駆動電流が2500mAで約600mWの光出力を得ることができる。従って、本実施形態例のダブルストライプ型半導体レーザモジュールは、高い光出力が要求されるラマン増幅器用の14XX（1300～1550）nm帯励起光源や、EDFA用の980nm帯や1480nm帯の励起光源として好適である。

【0081】

次に、本発明の第1の実施形態例に係る半導体レーザモジュールM1の製造方

法について説明する。

【0082】

まず、第1の基台17の平坦部17a上に第2の基台18を銀ろう付けして固定する。

【0083】

次いで、半導体レーザ素子2を固定したチップキャリア11と、フォトダイオード3を固定したフォトダイオードキャリア12を第1の基台17上に半田付けして固定する。

【0084】

次いで、第2の基台18上に第1レンズ4を調芯して固定する。この第1レンズ4の調芯工程では、半導体レーザ素子2に電流を供給して第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2を半導体レーザ素子2の第1のストライプ9及び第2のストライプ10の双方から出射させ、その出射方向を基準方向として設定した後、第1レンズ4を挿入し、XYZ軸方向の位置を決める。

【0085】

図7は、第1レンズ4の調芯工程を説明するための説明図である。X軸方向については、図7(A)に示すように、上記のようにして設定された基準方向(中心軸C2)と第1のレーザ光K1との角度 θ_1 と、中心軸C2と第2のレーザ光K2との角度 θ_2 とが等しくなる位置で決める。Y軸方向については、図7(B)に示すように、第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2が第1レンズ4の中心を通る位置で決める。Z軸については、半導体レーザ素子2からの規定の距離で、レーザ光のスポット径が最小となる位置で決める。以上の調芯工程で決まった位置で第1レンズ4を保持する第1のレンズ保持部材13を、第2の基台18上に第1の支持部材19aを介してYAGレーザ溶接して固定する。

【0086】

次いで、第2の基台18上に、プリズム5、半波長板6、光合成部材7を一体化した偏波合成モジュール59を調芯して固定する。この偏波合成モジュール59の調芯工程では、位置合わせ用光ファイバコリメータを用いて、そのファイバに結合する光強度が最大になるように、ホルダ部材14の中心軸C1(図4参照

）回り θ 、XYZ軸方向の位置を決める。ホルダ部材14の中心軸C1回りの位置決めでは、ホルダ部材14を中心軸C1の周りに回転させて第1の入力部7aに入射した第1のレーザ光K1と第2の入力部7bに入射した第2のレーザ光K2がともに出力部7cから出射されるように位置調整する。

【0087】

Z軸方向の位置決めでは、光合成部材7から出力されたレーザ光K1、K2のXY平面上での重なり具合を調節する。例えば完全に重ねることもできるし、互いのビームスポットの位置をずらしておくこともできる。後者はレーザ光K1、K2の光強度が異なっていた場合、光強度の小さい方の光をより多く受光するように、光ファイバ8を調芯することにより、光ファイバ8に入射されるレーザ光K1、K2の光強度を均等にして、偏光度を十分に下げることができるので好ましい。

【0088】

以上の調芯工程で決まった位置でホルダ部材14を第2の基台18上に第2の支持部材19bを介してYAGレーザ溶接して固定する。

【0089】

次いで、第1の基台17を、予めパッケージ1の底板上に固定された冷却装置20上に半田付けして固定する。

【0090】

次いで、半導体レーザ素子2及びモニタ用のフォトダイオード3は、金ワイヤ（図示せず）を介してパッケージ1のリード（図示せず）と電氣的に接続される。

【0091】

次いで、不活性ガス（例えばN₂、Xe）雰囲気においてパッケージ1上部に蓋1cを被せて、その周縁部を抵抗溶接することにより気密封止する。

【0092】

次いで、パッケージ1のフランジ部1aに対し第2レンズ16をXY面内及びZ軸方向で調芯して固定する。この工程では、第2レンズ16の出射光がパッケージ1のフランジ部1aの中心軸と平行となる位置でYAGレーザ溶接により固

定する。

【0093】

最後に、光ファイバ8を調芯して固定する。この工程では、第2のレンズ保持部材21の端部に金属製のスライドリング22を固定する。スライドリング22は、第2のレンズ保持部材21の端面において、光ファイバ8の光軸と垂直な面内(XY平面)で位置調整後、両者の境界部においてYAGレーザ溶接して固定される。光ファイバ8を保持するフェルール23は、光ファイバ8の出射が最大となる位置で、スライドリング22の内部にYAGレーザ溶接により固定される。その際、光ファイバ8は、合成される複数のレーザ光のパワーバランスを考慮して調芯される。これにより光ファイバ8の光軸方向(Z軸方向)の位置が固定される。

【0094】

ここで、本発明の実施形態例の半導体レーザモジュールに使用される半導体レーザ素子2について説明する。図8(A)～(C)は本発明の半導体レーザモジュールに使用される半導体レーザ素子2の構成を説明するための説明図、図9は半導体レーザ素子2の他の例を示す説明図である。なお、図8(B)及び(C)は図8(A)のa-a線断面図である。

【0095】

図8(A)に示すように、半導体レーザ素子2は、例えば有機金属気相成長法、液相法、分子線エピタキシャル成長法、ガスソース分子線エピタキシャル成長法等の公知のエピタキシャル成長法により、所定の半導体からなる基板24の上に、所定の半導体のエピタキシャル結晶成長を行って後述する積層構造25を形成した後、基板24の底面に下部電極26、積層構造25の上面に上部電極27を形成し、へき開を行って所定の共振器長L3とし、更に一方のへき開面(前端面2a)に低反射膜28(例えば反射率5%以下)を成膜し、他方のへき開面(後端面2b)に高反射膜29(例えば反射率9%以上)を成膜した構造になっている。

【0096】

図8(B)に示すように、基板24上の積層構造25は、例えば埋め込み型B

H (Buried Heterostructure) 構造になっていて、例えば n -InP から成る基板 24 の上に、例えば n -InP から成る下部クラッド層 30、例えばノンドープ GaInAsP から成る下部 Grin-SCH 層 31、例えば GaInAsP から成る活性層 32、例えばノンドープ GaInAsP から成る上部 Grin-SCH 層 33 が順次積層されており、更に、上部 Grin-SCH 層 33 の上に、例えば p -InP から成る上部クラッド層 34、例えば p -GaInAsP から成るキャップ層 35 が積層されている。そして、このキャップ層 35 の上に上部電極 27 が形成され、また基板 24 の底面には下部電極 26 が形成されている。

【0097】

そして、上記した下部クラッド層 30、下部 Grin-SCH 層 31、活性層 32、上部 Grin-SCH 層 33 は、 $40\mu\text{m}$ の間隔を介して互いに平行に並んだ 2 本のストライプ状に加工され、その側面に例えば p -InP 層 36 と n -InP 層 37 をこの順序で積層することにより、活性層 32 への電流注入用の狭窄部が形成されている。

【0098】

上記した活性層 32 としては、例えば、基板 24 に対する格子不整合率が 0.5% 以上 1.5% 以下となるような圧縮歪み量子井戸構造を採用し、かつ井戸数が 5 個程度の多重量子井戸構造を使用するのが、高出力化の観点から有利である。また、歪み量子井戸構造として、その障壁層を井戸層の歪みと反対の引っ張り歪みを導入して成る歪み補償構造とすれば、等価的に格子整合条件を満たすことができるため、井戸層の格子不整合度に関しては上限を設けることは必要ではない。

【0099】

本実施形態例では、下部 Grin-SCH 層 31、活性層 32、上部 Grin-SCH 層 33 からなる発光部が、図 8 の紙面に垂直な方向にストライプ状に延びて形成されており、この部分をそれぞれストライプ 9, 10 と称する。

【0100】

次に、上記の構造の半導体レーザ素子 2 の製造方法について説明する。

【0101】

まず、有機金属気相成長法、液相法、分子線エピタキシャル成長法、ガスソース分子線エピタキシャル成長法等の公知のエピタキシャル成長法により、基板 24 の上に、下部クラッド層 30、下部 Gr i n - S C H 層 31、活性層 32、上部 Gr i n - S C H 層 33、上部クラッド層 34 の順に積層する。

【0102】

次いで、 $40\mu\text{m}$ の間隔を介して互いに平行に並んだ 2 本のマスクを上記上部クラッド層 34 上に形成してから、所定のエッチャントを用いて上部クラッド層 34、上部 Gr i n - S C H 層 33、活性層 32、下部 Gr i n - S C H 層 31、及び下部クラッド層 30 の一部を溶解し、上記ストライプ上にさらに、p - I n P 層 36 と n - I n P 層 37 をこの順序で積層することによって、活性層 32 への電流注入用の狭窄部を形成する。

【0103】

次いで、p - I n P から成る上部クラッド層 34 が上記のエッチングにより溶解されているので、上部クラッド層 34 を再度結晶成長させて積層する。

【0104】

また、上部クラッド層 34 上にキャップ層 35 を積層する。

【0105】

次いで、キャップ層 35 の上面に上部電極 27 を形成し、基板 24 の底面に下部電極 26 を形成する。

【0106】

その後、へき開を行って所定の共振器長 L_3 とし、更に一方のへき開面（前端面 2 a）に低反射膜 28 を成膜し、他方のへき開面（後端面 2 b）に高反射膜 29 を成膜する。

【0107】

このようにして作製された半導体レーザ素子 2 は、上部電極 27 側を、図 1（B）に示すヒートシンク 58 に A u S n 半田等により接着される。そして、2 つのストライプは、上部電極 27（本実施形態例では p 側）及び下部電極 26（本実施形態例では n 側）を通して外部より供給される電流により、同時にレーザ発振し、低反射膜 28 からの 2 つの出射光が前述した光合成部材 7 により合波され

て所望の用途に供される。

【0108】

ここで、2つのストライプの特性が全く同じであるとする、本実施形態例に係る半導体レーザ素子2のしきい値電流は、ストライプ1本のしきい値電流の2倍、全光出力は、ストライプ1本の光出力の2倍となる。すなわち、半導体レーザ素子2全体としては、ストライプ1本当たりの駆動電流の約2倍の駆動電流で約2倍の光出力が得られ、半導体レーザ素子2のスロープ効率は1本のストライプを有する半導体レーザ素子2と変わらない。

【0109】

なお、上記した例では、2つのストライプが同時に駆動される構造を示したが、例えば図8(C)に示すように、2つのストライプの間に上部電極27から下部クラッド層30の深さにまで及ぶ分離溝38を形成し、その分離溝38表面を絶縁膜39で被覆することにより、2つのストライプを電氣的に分離することができる。このような半導体レーザ素子2の下部電極26側を、図示しないヒートシンクにAuSn半田等により接着すれば、2つのストライプに供給する駆動電流を独立に制御することも可能となり、光ファイバ8から出射されるレーザ光の偏光面をランダム化することが容易となる。

【0110】

なお、図8(C)に示す半導体レーザ素子2の構造の場合、一方のストライプだけに駆動電流を印加して使用し、一方のストライプの活性層が異常になった場合に、他方のストライプに駆動電流を印加して使用するようにしてもよい。この場合、片方のストライプを冗長系とすることになるので、半導体レーザ素子2の製品寿命を延ばすことができる。

【0111】

また、上部電極27側をヒートシンク58に接着して使用する場合には、ヒートシンク58側に、上部電極27に対応した電極パターンを形成しておくことにより、これら2つのストライプを独立に駆動することができる。

【0112】

また、上記した例では、半導体レーザ素子2は、InP系の埋め込み型BH構

造のものを説明したが、例えば図9に示すようなGaAs系のリッジ導波路型の半導体レーザ素子2であってもよい。図9に示すように、この半導体レーザ素子2は、n-GaAsからなる基板40上に、n型下部クラッド層41、活性層42、p型上部クラッド層43、絶縁層44、p-GaAs層45を積層し、2つのリッジ部が形成されている。絶縁層44及びp-GaAs層45上には上部電極（p電極）46が形成され、基板40の底面には下部電極（n電極）47が形成されている。

【0113】

リッジ部は、図9の紙面に垂直な方向にストライプ状に延びて形成され、当該リッジ部直下の部分の活性層42がそれぞれ発光する。この発光部をそれぞれストライプ9、10と称する。

【0114】

さらに、本実施形態例では、半導体レーザ素子2の基本構造となるファブリ・ペロー型の半導体レーザ素子2を説明したが、本実施形態例では、後述するように、DFB、DBR等の波長選択手段を具備した半導体レーザ素子2を用いる。このような半導体レーザ素子2を使用すれば、FBG付の光ファイバ8を使用しなくても、発振波長の安定化された光出力を得ることが可能となる。

（第2の実施形態例）

図10は、本発明の第2の実施形態例に係る半導体レーザモジュールM2の構成を模式化して示す説明図である。図10に示すように、第2の実施形態例では、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するように、光合成部材7の第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2の入射面が楔形に傾斜して形成されている。第2の実施形態例によれば、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するので、半波長板6と第1レンズ4との間にプリズム5を配設する必要がなくなり、構成を簡単にすることができる。

【0115】

また、半導体レーザモジュールM2の光軸方向の長さを短くできるので、高温状態における光出力特性に対するパッケージの反りの影響を低減できる。

【0116】

なお、第2の実施形態例においても、中心軸周りの角度調整を容易にするため、半波長板6と光合成部材7とを同一のホルダ部材14に固定し偏波合成モジュールとして構成してもよい。

(第3の実施形態例)

図11は、本発明の第3の実施形態例に係る半導体レーザモジュールM3の構成を模式化して示す説明図である。図11に示すように、第3の実施形態例では、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するように、半導体レーザ素子2及び第1レンズ4は、軸線方向に対して所定角度傾斜して配置されている。第3の実施形態例によれば、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するので、半波長板6と第1レンズ4との間にプリズム5を配設する必要がなくなり、構成を簡単にすることができる。また、光合成部材7の研磨を片方だけ行えばよいので、第2の実施形態例に比べ研磨の簡略化が可能となる。

【0117】

また、半導体レーザモジュールM3の光軸方向の長さを短くできるので、高温状態における光出力特性に対するパッケージの反りの影響を低減できる。

【0118】

なお、第3の実施形態例においても、中心軸周りの角度調整を容易にするため、半波長板6と光合成部材7とを同一のホルダ部材14に固定し偏波合成モジュールとして構成してもよい。

【0119】

上記の実施形態例に係る半導体レーザモジュールM1～M3は、高出力で偏光度が小さく、波長が安定したレーザ光を出射することができるので、エルビウムドープ光増幅器やラマン増幅器の励起光源として用いることが可能である。

(第4の実施形態例)

図12は、本実施形態例の半導体レーザモジュールに用いられ、図4に示す偏波合成モジュール59とは異なる構成の第4の実施形態例の偏波合成モジュール60を示す分解斜視図、図13は、図12の偏波合成モジュール60を示す側面

断面図である。なお、図 4 の偏波合成モジュール 59 と同一の部材は同一の符号を付して説明を省略する。

【0120】

図 12 及び図 13 に示すように、第 4 の実施形態例の偏波合成モジュール 60 は、長手方向に溝部 61a が形成されたホルダ部材 61 と、ホルダ部材 61 の溝部 61a に嵌って配置される第 1 の調整シート 62 及び第 2 の調整シート 63 と、第 1 の調整シート 62 上に配置されるプリズム 5 と、第 2 の調整シート 63 上に配置される光合成部材 7 と、ホルダ部材 61 の溝部 61a に嵌って配置される半波長板ホルダ 64 と、半波長板ホルダ 64 に保持される半波長板 6 と、ホルダ部材 61 の溝部 61a の開口側に形成された段差部 61b に嵌って固定される板状のボトムカバー 65 とを有する。

【0121】

ホルダ部材 61、半波長板ホルダ 64 及びボトムカバー 65 は、YAG レーザ溶接の可能な材質（例えばコバルト）で作られている。

【0122】

半波長板 6 の上部はメタライズされ、半波長板ホルダ 64 の上部は金メッキされており、半波長板 6 の上部と半波長板ホルダ 64 の上部とが半田付けされて固定される。

【0123】

第 1 の調整シート 62 及び第 2 の調整シート 63 は、プリズム 5 及び光合成部材 7 の位置決めを容易にするために変形可能な材質で作られており、例えば、ソフトメタル（In 等）、半田シート（Sn-Pb 等）のような柔軟部材や樹脂等の弾性部材で作られている。

【0124】

偏波合成モジュール 60 は又、ホルダ部材 61 の溝部 61a の両端部に YAG レーザ溶接で固定される第 1 のストッパー 66 及び第 2 のストッパー 67 が取り付けられる。図 13 に示すように、第 1 のストッパー 66 及び半波長板ホルダ 64 は、第 1 の調整シート 62 を挟んで保持することにより、第 1 の調整シート 62 の流れ止めとしての役割を有する。また、第 2 のストッパー 67 及び半波長板

ホルダ 64 は、第 2 の調整シート 63 を挟んで保持することにより、第 2 の調整シート 63 の流れ止めとしての役割を有する。

【0125】

なお、第 1 のストッパー 66 及び第 2 のストッパー 67 は、予めホルダ部材 61 に一体に成形されていてもよい。

【0126】

次に、第 4 の実施形態例の偏波合成モジュール 60 の組立方法について説明する。まず、ホルダ部材 61 の溝部 61a の両端部に第 1 のストッパー 66 及び第 2 のストッパー 67 を YAG レーザ溶接で固定する。

【0127】

次いで、半波長板 6 を半波長板ホルダ 64 に半田付けして保持する。

【0128】

次いで、半波長板 6 を保持した半波長板ホルダ 64 をホルダ部材 61 の溝部 61a に YAG レーザ溶接して固定する。その際、第 1 のストッパー 62 及び第 2 のストッパー 63 と半波長板ホルダ 64 との間に第 1 の調整シート 62 及び第 2 の調整シート 63 がそれぞれ嵌るように、半波長板ホルダ 64 を位置決めする。

【0129】

次いで、第 1 のストッパー 66 と半波長板ホルダ 64 との間のホルダ部材 61 の溝部 61a に第 1 の調整シート 62 を嵌めて配置する。また、第 2 のストッパー 67 と半波長板ホルダ 64 との間にホルダ部材 61 の溝部 61a に第 2 の調整シート 63 を嵌めて配置する。

【0130】

次いで、第 1 の調整シート 62 上にプリズム 5 を載置し、第 2 の調整シート 63 上に光合成部材 7 を載置する。

【0131】

次いで、ホルダ部材 61 の溝部 61a の開口側に形成された段差部 61b にボトムカバー 65 を嵌める。プリズム 5 及び光合成部材 7 は、ボトムカバー 65 の裏面 65a と面接触して押圧される。これによって、第 1 の調整シート 62 及び第 2 の調整シート 63 が変形し、プリズム 5 及び光合成部材 7 は所望の位置に位

置決めされる。

【0132】

最後に、ボトムカバー 65 とホルダ部材 61 とを YAG レーザ溶接で固定する。

【0133】

この偏波合成モジュール 60 によれば、プリズム 5 及び光合成部材 7 がボトムカバー 65 の裏面 65a と面接触して押圧され、第 1 の調整シート 62 及び第 2 のシート 63 の変形により、位置決めされる。ボトムカバー 65 の裏面 65a は、溝部 61a 表面よりも加工精度が高い平面に形成される。そのため、ボトムカバー 65 に面接触されたプリズム 5 及び光合成部材 7 の光軸回りの回転方向 θ を精度よく位置決めすることができる。

【0134】

なお、プリズム 5 及び光合成部材 7 に金メッキを施し、ホルダ部材 61 の溝部 61a に直接、半田付けして固定してもよい。この場合、第 1 の調整シート 62 及び第 2 の調整シート 63 は不要となるが、溝部 61a の加工面を精度よく形成することが必要となる。

(第 5 の実施形態例)

上述した半導体レーザー素子 2 の第 1 のストライプ 9 と第 2 のストライプ 10 は、互いに長手方向に平行に延びて形成されているが、これに限らず例えば図 14 に示すように、傾斜して形成されていてもよい。この場合、2 本のストライプ 9, 10 から出射される 2 本のレーザー光は半導体レーザー素子 2 から短距離で交差するので、第 1 のレーザー光 K1 及び第 2 のレーザー光 K2 が第 1 レンズ 4 を通過後、分離する（図 2 において D' が十分大きくなることをいう）ために必要な伝搬距離（図 2 における L）が短くなるため、半導体レーザーモジュール M の光軸方向の長さを短くすることができる。

(第 6 の実施形態例)

図 15 (A) ~ (C) は、本発明の実施形態例に係る半導体レーザーモジュールに使用され、図 8 に示す半導体レーザー素子 2 とは異なる構成の第 6 の実施形態例の半導体レーザー素子 68 を示す。図 15 (B) 及び (C) は、それぞれ図 15 (

A) の b-b 線断面図、c-c 線断面図である。

【0135】

図15に示すように、第6の実施形態例の半導体レーザ素子68は、n-Inp基板69の(100)面上に、順次、n-InPによるバッファ層と下部クラッド層とを兼ねたn-InPバッファ層70、GRIN-SCH-MQW(分布屈折率分離閉込め多重量子井戸)活性層71、p-InPスペーサ層72、およびp-InPクラッド層73、InGaAsPギャップ層74が積層された構造を有する。

【0136】

2つのストライプの各p-InPスペーサ層72内には、それぞれ膜厚20nmを有したp-InGaAsの回折格子75が、ピッチ約230nmで周期的に形成されている。この回折格子75により、中心波長1.48nmのレーザ光を選択するようにしている。この回折格子75を含むp-InPスペーサ層72、GRIN-SCH-MQW活性層71及びn-InPバッファ層70上部は、メサストライプ状に加工され、メサストライプの両側は、電流ブロッキング層として形成されたp-InPブロッキング層76とn-InPブロッキング層77によって埋め込まれている。また、InGaAsPギャップ層74の上面には、P側電極78が形成され、n-InP基板69の裏面には、n側電極79が形成されている。

【0137】

半導体レーザ素子68の長手方向の一端面である光反射端面には、反射率80%以上の高光反射率をもつ第1の反射膜80が形成され、他端面である光出力端面には、反射率が1~5%の低光反射率をもつ第2の反射膜81が形成される。第1の反射膜80と第2の反射膜81とによって形成された光共振器のGRIN-SCH-MQW活性層71内に発生した光は、第1の反射膜80によって反射し、第2の反射膜81を介し、レーザ光として出射される。

【0138】

半導体レーザ素子68は、例えばラマン増幅器の励起用光源として用いられる場合、その発振波長 λ_0 は、1300nm~1550nmであり、共振器長LRは

、800 μm 以上3200 μm 以下に設定される。

【0139】

ところで、一般に、半導体レーザ素子の共振器によって発生する縦モードのモード間隔 $\Delta\lambda$ は、等価屈折率を「 n 」とすると、次式で表すことができる。すなわち、

$$\Delta\lambda = \lambda_0^2 / (2 \cdot n \cdot L)$$

である。ここで、発振波長 λ_0 を1480 μm とし、等価屈折率を3.5とすると、共振器長が800 μm のとき、縦モードのモード間隔 $\Delta\lambda$ は、約0.39 nmとなり、共振器長が3200 μm のとき、縦モードのモード間隔 $\Delta\lambda$ は、約0.1 nmとなる。すなわち、共振器長を長くすればするほど、縦モードのモード間隔 $\Delta\lambda$ は狭くなり、単一縦モードのレーザ光を発振するための選択条件が厳しくなる。

【0140】

一方、回折格子75は、そのブラッグ波長によって縦モードを選択する。この回折格子75による選択波長特性は、図16に示す発振波長スペクトル82として表される。図16に示すように、この実施の形態例では、回折格子75を有した半導体レーザ素子による発振波長スペクトルの半値幅 $\Delta\lambda_h$ で示される波長選択特性内に、発振縦モードを複数存在させるようにしている。従来の半導体レーザ素子では、共振器長LRを800 μm 以上とすると、単一縦モード発振が困難であったため、かかる共振器長LRを有した半導体レーザ素子は用いられなかった。しかしながら、この実施の形態例の半導体レーザ素子68では、共振器長LRを積極的に800 μm 以上とすることによって、発振波長スペクトルの半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に複数の発振縦モードを含ませてレーザ出射するようにしている。図16では、発振波長スペクトルの半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に3つの発振縦モード83a~83cを有している。

【0141】

複数の発振縦モードを有するレーザ光を用いると、単一縦モードのレーザ光を用いた場合に比して、レーザ出射のピーク値を抑えて、高いレーザ出力値を得ることができる。例えば、この実施の形態例に示した半導体レーザ素子68では、

図17 (B) に示すプロファイルを有し、低いピーク値で高レーザ出力を得ることができる。これに対し、図17 (A) は、同じレーザ出力を得る場合の単縦モード発振の半導体レーザ素子のプロファイルであり、高いピーク値を有している。

【0142】

ここで、半導体レーザ素子をラマン増幅器の励起用光源として用いる場合、ラマン利得を大きくするために励起光出力パワーを増大することが好ましいが、そのピーク値が高いと、誘導ブリルアン散乱が発生し、雑音が増加するという不具合が発生する。誘導ブリルアン散乱の発生は、誘導ブリルアン散乱が発生するしきい値 P_{th} を有し、同じレーザ出力パワーを得る場合、図17 (B) に示すように、複数の発振縦モードを持たせ、そのピーク値を抑えることによって、誘導ブリルアン散乱のしきい値 P_{th} 内で、高い励起光出力パワーを得ることができ、その結果、高いラマン利得を得ることが可能となる。

【0143】

また、図16 に示すように、発振縦モード83a～83cの波長間隔（モード間隔） $\Delta\lambda$ は、0.1nm以上としている。これは、半導体レーザ素子68をラマン増幅器の励起用光源として用いる場合、モード間隔 $\Delta\lambda$ が0.1nm以上であると、誘導ブリルアン散乱が発生する可能性が高くなるからである。その結果、上述したモード間隔 $\Delta\lambda$ の式によって、上述した共振器長 L_R が3200 μm 以下であることが好ましいことになる。

【0144】

一方、発振波長スペクトルの半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に含まれる発振縦モードの本数は、3本以上であることが好ましい。これは、半導体レーザ素子をラマン増幅器の励起用光源として用いる場合、ラマン増幅が、信号光の偏波方向と励起光の偏波方向とを一致させた状態で生じるという偏波依存性を有しているため、半導体レーザ素子から出射された励起光を偏波保存ファイバを用いて偏波合成し、偏光がない励起光とする必要がある。一般に、発振縦モードの本数が増大するに従って、必要な偏波保存ファイバの長さを短くすることができる。特に、発振縦モードが4、5本となると、急激に、必要な偏波保存ファイバの長さが短くなる。した

がって、発振縦モードの本数を 3 本以上、特に 4 本以上とすることによって、ラマン増幅器に用いる偏波保存ファイバの長さを短くすることができ、ラマン増幅器の小型を簡素化し、小型化を促進する。

【0145】

さらに、発振縦モードの本数が増大すると、コヒーレント長が短くなり、デполяライズによって偏光度が小さくなり、偏波依存性をなくすることが可能となり、これによっても、ラマン増幅器の簡素化と小型化とを促進することができる。

【0146】

ここで、発振波長スペクトル幅が広すぎると、波長合成カプラによる合波ロスが大きくなるとともに、発振波長スペクトル幅内における波長の動きによって、雑音や利得変動を発生させることになる。このため、発振波長スペクトル 82 の半値幅 $\Delta\lambda_h$ は、3 nm 以下、好ましくは 2 nm 以下とする必要がある。

【0147】

さらに、ファイバブラッググレーディングを用いた半導体レーザモジュールの場合、FBG と光反射面との間の共振によって相対強度雑音 (RIN) が大きくなり、安定したラマン増幅を行うことができない場合がある。これに対し、この実施の形態例の半導体レーザ素子 68 を用いた半導体レーザモジュールでは、FBG を用いる必要がなく、第 2 の反射膜 81 から出射したレーザ光をそのまま、ラマン増幅器の励起用光源として用いることができるため、相対強度雑音が小さくなり、その結果、ラマン利得の揺らぎが小さくなり、安定したラマン増幅を行わせることができる。

【0148】

また、FBG を用いた半導体レーザモジュールでは、半導体半導体レーザ素子の光反射面と光出力面とが形成する共振器構造によって増幅された微弱なレーザ光が出射され、本来、光反射面と FBG とによって選択されるレーザ光に影響を与え、注入電流-光出力特性上にキックを生じさせ、光出力を不安定なものにするという不具合があった。これに対し、この実施の形態例の半導体レーザ素子 68 を用いた半導体レーザモジュールでは、FBG を用いる必要がないため、安定した光出力を得ることができる。この結果、ラマン増幅器の励起用光源として用

いる場合に、安定したラマン増幅を行わせることができる。

【0149】

さらに、FBGを用いた半導体レーザモジュールの場合、FBGを有する光ファイバと半導体レーザ素子とを光結合させる必要があるため、半導体レーザ素子の組立時における光軸合わせが必要となり、そのための時間と労力とがかかる。これに対し、この実施の形態例の半導体レーザ素子68では、共振器ではなく、光出力のための光軸合わせであるため、その組立が容易となる。

【0150】

また、FBGを用いた半導体レーザモジュールの場合、共振器内に機械的な結合を必要とするため、振動などによってレーザの発振特性が変化する場合が発生する。これに対し、この実施の形態例の半導体レーザ素子68では、機械的な振動などによるレーザの発振特性の変化がなく、安定した光出力を得ることができる。

【0151】

この実施の形態例によれば、半導体レーザ素子68が回折格子75によって波長選択を行い、発振波長を1300～1550 μ m帯とし、共振器長LRを800～3200 μ m帯とすることによって、発振波長スペクトル82の半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に複数の発振縦モード、好ましくは4本以上の発振縦モードをもつレーザ光を出射するようにしている。その結果、ラマン増幅器の励起用光源として用いた場合に誘導ブリルアン散乱を発生せずに、安定し、かつ高いラマン利得を得ることができる。

【0152】

また、FBGをもつ光ファイバと半導体レーザ素子との光結合を共振器内において行わないので、組立が容易となり、機械的振動などによる不安定出射を回避することができる。

(第7の実施形態例)

図18(A)～(C)は第7の実施形態例である半導体レーザ素子の構成を示す長手方向の縦断面図である。

【0153】

上述した実施の形態例では、共振器長 L_R を長くすることによって、発振波長スペクトル 82 の半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内の縦モード数が複数となるようにしている。これに対し、第 7 の実施形態例では、回折格子のグレーティング長 L_G あるいは結合係数を変化させることによって、発振波長スペクトル 82 の半値幅 $\Delta\lambda_h$ を変化させ、これによって半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内の縦モード数が相対的に複数となるようにしている。

【0154】

図 18 (A) に示すように、半導体レーザ素子 84a は、回折格子 75 の配置構成が、第 6 の実施形態例に係る半導体レーザ素子 68 と異なるとともに、第 2 の反射膜 81 の反射率が異なる。その他の構成は、半導体レーザ素子 68 と同じであり、同一構成部分には、同一符号を付して、説明を省略する。

【0155】

回折格子 75 は、反射率 0.1~2% の低光反射率をもつ第 2 の反射膜 81 から反射率 80% 以上の高光反射率をもつ第 1 の反射膜 80 側に向けて所定長 L_G 1 分、形成され、所定長 L_G 1 以外の $p-i-n$ スペーサ層 72 には、回折格子 75 が形成されていない。

【0156】

また、図 18 (B) は、第 7 の実施形態例の変形例である半導体レーザ素子 84b の構成を示す長手方向の縦断面図である。この半導体レーザ素子 84b は、第 1 の反射膜 80 側に設けた回折格子 75 を有するとともに、第 1 の反射膜 80 の反射率を低光反射率としている。すなわち、回折格子 75 は、反射率 0.1~2% の低光反射率をもつ第 1 の反射膜 80 から反射率 1~5% の低光反射率をもつ第 2 の反射膜 81 側に向けて所定長 L_G 2 分、形成され、所定長 L_G 2 以外の $p-i-n$ スペーサ層 72 には、回折格子 75 が形成されない。

【0157】

さらに、図 18 (C) は、第 7 の実施形態例のさらなる変形例である半導体レーザ素子 84c の構成を示す長手方向の縦断面図である。この半導体レーザ素子 84c は、図 18 (A) に示した回折格子 75 および図 18 (B) に示した回折格子 75 の構成を適用したものである。

【0158】

すなわち、この半導体レーザ素子 84c は、反射率 0.1~2% の低光反射率をもつ第 2 の反射膜 81 から反射率 0.1~2% の低光反射率をもつ第 1 の反射膜 80 側に向けて所定長 L_G 3 分、形成された回折格子 75 と、この第 1 の反射膜 80 から第 2 の反射膜 81 側に向けて所定長 L_G 4 分、形成された回折格子 75 とを有する。

【0159】

図 18 に示した回折格子 75 の所定長を変化させることによって、発振縦モードのモード間隔 $\Delta\lambda$ が固定的であっても、図 16 に示した発振波長スペクトル 82 の半値幅 $\Delta\lambda_h$ を変化させることができる。

【0160】

すなわち、発振波長スペクトル 82 の半値幅 $\Delta\lambda_h$ を広くするためには、回折格子 75 の長さを短くすることも有効である。このため、実施の形態例に示したように、回折格子 75 を共振器 (GRIN-SCH-MQW 活性層 71) の長さ全体に施すのではなく、この共振器の一部に形成するようにする。

【0161】

この場合、共振器に対する回折格子 75 の位置によっては、位相発振条件がずれ、これによってレーザ発振特性が悪化するおそれがあるため、図 18 (A) に示したように、回折格子 75 を、第 2 の反射膜 81 を起点として第 1 の反射膜 80 方向に、共振器の途中まで延ばして形成する場合、第 2 の反射膜 81 として 0.1~2% の反射率をもつ低光反射コートを施し、第 1 の反射膜 80 として 80% 以上の反射率をもつ高反射コートを施すようにする。また、図 18 (B) に示したように、回折格子 75 を、第 1 の反射膜 80 を起点として第 2 の反射膜 81 方向に、共振器の途中まで延ばして形成する場合、第 1 の反射膜 80 として 0.1~2% の反射率をもつ低光反射コートを施し、第 2 の反射膜 81 として反射率 1~5% の反射率をもつ低反射コートを施すようにする。さらに、図 18 (C) に示したように、回折格子 75 をそれぞれ第 2 の反射膜 81 側および第 1 の反射膜 80 側に形成する場合、第 2 の反射膜 81 および第 1 の反射膜 80 として、ともに反射率 0.1~2% の低光反射コートを施す。

【0162】

また、図18 (A) に示したように、回折格子75を第2の反射膜81側に形成する場合、回折格子75自体の反射率を低めに設定し、図18 (B) に示したように、回折格子75を第1の反射膜80側に形成する場合、回折格子75自体の反射率を高めに設定することが好ましい。また、図18 (C) に示したように、回折格子75を第2の反射膜81側および第1の反射膜80側の双方に形成する場合、回折格子75自体の反射率を低めに設定し、回折格子75自体の反射率を高めに設定する。これによって、回折格子75による波長選択特性を満足させつつ、第1の反射膜80および第2の反射膜81によるファブリペロー型共振器の影響を小さくすることができる。

【0163】

具体的に、図18 (A) に示した半導体レーザ素子では、共振器長LRが1300 μm であり、回折格子75のグレーティング長が230 μm 、結合係数KL Gが0.093である。また、図18 (B) に示した半導体レーザ素子では、共振器長LRが1300 μm であり、回折格子75のグレーティング長が400 μm 、結合係数KL Gが2.97である。このような回折格子75を適用した場合、発振波長スペクトル82の半値幅 $\Delta\lambda_h$ は、1~2 nmとなり、半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に3~5本軽度の発振縦モードを含ませることができる。

【0164】

また、図18では、回折格子75を、第2の反射膜81側または第1の反射膜80側、あるいは第2の反射膜81側および第1の反射膜80側に設けたが、これに限らず、GRIN-SCH-MQW活性層71に沿い、共振器長に対して部分的な長さをもつ回折格子75を形成するようにしてもよい。ただし、回折格子75の反射率を考慮することが好ましい。

【0165】

この第7の実施形態例では、共振器長LRに対する回折格子75の長さを部分的なものとし、この回折格子75のグレーティング長LGおよび結合係数KL Gを適切に変化させることによって、所望の発振波長スペクトル82の半値幅 $\Delta\lambda_h$ を得ることができ、この半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に複数の発振縦モードをもったレーザ光

を発振させることができ、第6の実施形態例と同様な作用効果をもった半導体レーザー素子を実現することができる。

(第8の実施形態例)

図19は本発明の第8の実施形態例である半導体レーザー素子の構成を示す長手方向の縦断面図である。

【0166】

上述した第6及び第7の実施形態例では、回折格子75のグレーティング周期は一定であったが、この第8の実施形態例では、回折格子75のグレーティング周期を周期的に変化させたチャープドグレーティングを用い、これによって、回折格子75の波長選択特性に揺らぎを発生させ、発振波長スペクトル82の半値幅 $\Delta\lambda_h$ を広げて、半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内の縦モード数が相対的に複数となるようにしている。

【0167】

図19に示すように、半導体レーザー素子85では、回折格子75のグレーティング周期を周期的に変化させたチャープドグレーティングである回折格子75を有している。その他の構成は、第6の実施形態例の半導体レーザー素子68と同じであり、同一構成部分には、同一符号を付して、説明を省略する。

【0168】

図20は、回折格子75のグレーティング周期の周期的変化を示す図である。図20に示すように、この回折格子75は、平均周期が230nmであり、 ± 0.15 nmの周期揺らぎ（偏差）を周期Cで繰り返す構造を有している。この ± 0.15 nmの周期揺らぎによって回折格子75の反射帯域は、約2nmの半値幅を有し、これによって、発振波長スペクトルの半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に3～6本程度の発振縦モードを持たせることができる。

【0169】

上述した第8の実施形態例では、共振器長LRに等しいチャープドグレーティングを形成するようにしていたが、これに限らず、第7の実施形態例に示したようにチャープドグレーティングの回折格子75を、共振器長LRに対して部分的に配置するようにしてもよい。すなわち、上述した第8の実施形態例に示したチ

ャープドグレーティングを第7の実施形態例に適用するようにしてもよい。

【0170】

また、上述した第8の実施形態例では、一定の周期Cでグレーティング周期を変化させるチャープドグレーティングとしたが、これに限らず、グレーティング周期を、周期 Λ_1 ($230\text{ nm} + 0.15\text{ nm}$) と周期 Λ_2 ($230\text{ nm} - 0.15\text{ nm}$) との間で、ランダムに変化させるようにしてもよい。

【0171】

さらに、図21 (A) に示すように、周期 Λ_1 と周期 Λ_2 とを1回ずつ交互に繰り返す回折格子75aとして、周期揺らぎを持たせるようにしてもよい。また、図21 (B) に示すように、周期 Λ_1 と周期 Λ_2 とをそれぞれ複数回、交互に繰り返す回折格子75bとして、周期揺らぎを持たせるようにしてもよい。さらに、図21 (C) に示すように、連続する複数回の周期 Λ_1 と連続する複数回の周期 Λ_2 とをもつ回折格子75cとして、周期揺らぎを持たせるようにしてもよい。また、周期 Λ_1 と周期 Λ_2 との間の離散的な異なる値をもつ周期を補完して配置するようにしてもよい。

【0172】

この第8の実施形態例では、半導体レーザ素子に設けられる回折格子75をチャープドグレーティングなどによって、平均周期に対して $\pm 0.05 \sim 0.2\text{ nm}$ 程度の周期揺らぎをもたせ、これによって、反射帯域の半値幅を所望の値に設定し、最終的に発振波長スペクトルの半値幅 $\Delta\lambda_h$ を決定し、半値幅 $\Delta\lambda_h$ 内に複数の発振縦モードが含まれるレーザ光を出力するようにし、第6の実施形態例あるいは第7の実施形態例と同様な作用効果をもった半導体レーザ素子を実現することができる。

(第9の実施形態例)

第6～第8の実施形態例の半導体レーザ素子では、2つのストライプに設けられた回折格子75で選択される波長は略同一である。これに対し、第9の実施形態例の半導体レーザ素子では、2つのストライプに設けられた回折格子75で選択される波長が異なるように選択して設定されている。

【0173】

2つのストライプの回折格子75で選択される波長がわずかにずれている場合（0.1以上3nm未満、例えば約0.5nm程度）、重ね合わせとして得られるスペクトルは、ラマン増幅で要求される波長半値幅内でより多くの縦モードを有する。これによって、DOPをより効果的に低減することができる。

【0174】

また、2つのストライプの回折格子75で選択される波長が、数nm～数十nm（例えば3nm以上）ずれていてもよい。ラマン増幅では通常全く異なる波長、例えば1430nmと1450nm等を組み合わせて励起光源として用いる。2つのストライプに回折格子75を設けることにより、上記2波長のレーザ光を出射するように、2つのストライプを設計することは可能である。つまり、1つの半導体レーザモジュールで波長合成されていることになるため、従来技術である2つの半導体レーザモジュールと外付けの波長合成カップラからなる構成が不要となり、小型化、省部品化が可能となる。

【0175】

第9の実施形態例では、光出力をそれぞれの波長で制御することが必要となる場合が多い。そこで、図8（C）に示すように、2つのストライプの間に分離溝38を形成し、その分離溝38表面を絶縁膜で被覆することにより、2つのストライプを電氣的に分離するのが好ましい。

【0176】

以上第6～第9実施形態例の回折格子75を任意に組み合わせて2つのストライプを形成することにより、半導体レーザモジュールから出力される光の波長の自由度が増加する。

【0177】

もちろん、このような2つのストライプから出射された光を波長合成する場合（偏波合成の必要がない場合）、半波長板6は不要である。

（第10の実施形態例）

第1～第5の実施形態例のように、2つのレーザ光を出射するダブルストライプ型半導体レーザモジュールでは、FBGを形成した偏波保存ファイバを取り付ける場合、偏波保存ファイバに偏光面を合わせて入れることが通常行われる。

【0178】

これに対し、第10の実施形態例では、2つのストライプに回折格子75を設けた第6～第9の実施形態例の半導体レーザ素子を用いて、FBGを不要とし、さらに偏波保存ファイバの偏光面を半導体レーザ素子の偏光面と45度ずれるように光結合している。これによって、偏波保存ファイバをデポラライザとして機能させることができ、DOPをより効果的に低減することができる。

(第11の実施形態例)

図22は、本発明の第11の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0179】

図22に示すように、第11の実施形態例では、2つのストライプに回折格子75を設けた第6～第10の実施形態例の半導体レーザ素子（総称して86とする）を用いて、光ファイバ8にFBG等の光反射部15を設ける必要をなくし、さらに、半導体レーザ素子86から出射された第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2を光ファイバ8に向かう方向だけ透過させる光アイソレータ94が、第1レンズ4と第2レンズ16との間に配置されている。光アイソレータ94を配置することにより、反射戻り光を防止して半導体レーザ素子86の動作を安定化させることができる。なお、光アイソレータ94は、第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2が平行になっている箇所、例えばプリズム5と半波長板6との間に配置されることにより、1つの光アイソレータ94で対応することができる。

(第12の実施形態例)

図23は、本発明の第12の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0180】

図23(A)に示すように、第12の実施形態例では、2つのストライプ9, 10を備えた半導体レーザ素子2から出射された第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2のうち、第2のレーザ光が第1レンズ4の中心点及び光ファイバ8の軸線方向を通過するように構成されていることを特徴としている。

【0181】

光合成部材 7 は、半導体レーザ素子 2 への反射戻り光を防止するために、Y 軸を中心に約 1° 回転させている。また、図 23 (B) に示すように、半導体レーザ素子 2 への反射戻り光を防止するために、光合成部材 7 の入射面を Z 軸方向に角度 β (例えば 4 度) だけ傾きを与えてもよい。

【0182】

第 12 の実施形態例によれば、第 2 のレーザ光 K 2 が第 1 レンズ 4 の中心点及び光ファイバ 8 の軸線方向を通過し、第 1 のレーザ光 K 1 が第 1 レンズ 4 によって第 2 のレーザ光 K 2 との間隔を広げられるので、プリズムを設ける必要がなくなり、構成を簡単にすることができる。

【0183】

また、半導体レーザモジュールの光軸方向の長さを短くできるので、高温状態における光出力特性に対するパッケージの反りの影響を低減できる。

【0184】

なお、第 12 の実施形態例においても、中心軸周りの角度調整を容易にするため、半波長板 6 と光合成部材 7 とを同一のホルダ部材 14 に固定し偏波合成モジュールとして構成してもよい。

(第 13 の実施形態例)

図 24 は、本発明の第 13 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0185】

図 24 に示すように、第 13 の実施形態例では、複数 (図 24 の例では 2 つ) のプリズム 5、5 が光軸方向に沿って設けられていることを特徴としている。第 13 の実施形態例によれば、2 つのレーザ光 K 1、K 2 を精度よく平行にすることが可能となる。

(第 14 の実施形態例)

図 25 は、本発明の第 14 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0186】

図 25 に示すように、第 14 の実施形態例では、第 1 レンズ 4 を通過した第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 とが略重なる位置にプリズム 5 の入射面が配置されていることを特徴としている。第 14 の実施形態例によれば、プリズム 5 を通過した略重なった 2 つのレーザ光 K 1、K 2 を集光レンズ 6 に入射させることになるので、光合成部材 7 が必要がなくなり、構成をより簡単にすることができる。

【0187】

また、半導体レーザモジュールの光軸方向の長さを短くできるので、高温状態における光出力特性に対するパッケージの反りの影響を低減できる。

(第 15 の実施形態例)

図 26 は、本発明の第 15 の実施形態例に係るフォトダイオード (受光素子) 3 の例を示す説明図である。

【0188】

フォトダイオード 3 は、図 26 (A) に示すように、半導体レーザ素子 2 の各ストライプ 9、10 の後側端面から出射された光を受光する導波路型受光素子であってもよい。

【0189】

また、フォトダイオード 3 は、図 26 (B) に示すように、半導体レーザ素子 2 の各ストライプ 9、10 の他方側端面から出射された各光を受光してモニタするように複数設けられていてもよい。この場合、半導体レーザ素子 2 とフォトダイオード 3 との間に、半導体レーザ素子 2 から出射された各光の間隔を広げるように分離させるレンズ 95 を配置するのが好ましい。

【0190】

さらに、フォトダイオード 3 は、光合成部材 7 によって反射された光をそれぞれ受光してモニタしてもよい。

【0191】

フォトダイオード 3 のモニタ結果に基づいて、例えば APC (Auto Power Control) 回路によってそれぞれ半導体レーザ素子 2 への駆動電流量を調整して光出力が一定に制御される。

【0192】

これらの構成によれば、2つのストライプそれぞれに独立してAPC制御をかけることが可能となり、レーザ光K1、K2を任意の光強度バランスに保つことができる。

(第16の実施形態例)

図27は、本発明の第16の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0193】

図27(A)に示すように、第16の実施形態例に係る半導体レーザモジュールは、間隔を隔てて形成された複数(図27の例では2つ)のストライプ9、10を有し、各ストライプ9、10の前側端面から複数のレーザ光K1、K2を出射する半導体レーザ素子2と、半導体レーザ素子2から出射された複数のレーザ光を別焦点に集光させる第1レンズ4と、第1レンズ4を通過した複数のレーザ光を光合成する光合成部材7と、光合成手段7から出射されるレーザ光を受光し外部に送出する光ファイバ8とを有する。

【0194】

半導体レーザ素子2のストライプ9、10には前述した回折格子75が設けられ、ストライプ9、10から各々異なる波長でレーザ光が出射される。

【0195】

第16の実施形態例では、光合成部材7として、図27(B)に示すようにクサビ形プリズムが用いられている。このクサビ形プリズムの入射側表面には、波長に応じて光を反射又は透過する波長選択フィルタ7aが設けられている。波長選択フィルタ7aは、例えば誘電体多層膜により形成されている。波長選択フィルタ7aは、第1のレーザ光K1の光を反射し、第2のレーザ光K2の光を透過する。

【0196】

図28は、波長選択フィルタ7aに入射したときの光透過率を示すグラフである。図28に示すように、波長選択フィルタ7aへの入射角度の違いにより光の透過率に違いがあり、入射角度が θ bの場合には、入射する光の波長が λ x(θ

b) 以下の光はほぼ100%透過し、 $\lambda_x(\theta b)$ よりも長い光はほぼ100%反射する。また、入射角度が θa の場合には、入射する光の波長が $\lambda_x(\theta a)$ 以下の光はほぼ100%透過し、 $\lambda_x(\theta a)$ よりも長い光はほぼ100%反射する。

【0197】

また、このクサビ形プリズムの出射側表面には、全ての波長の光を反射する全反射膜7bと、光の反射を防止する反射防止膜7cが設けられている。

【0198】

第17の実施形態例によれば、レーザ光K1の波長を λa 、波長選択フィルタ7aへの入射角度を θa に設定し、レーザ光K2の波長を λb 、波長選択フィルタ7aへの入射角度を θb に設定する。

【0199】

第1のレーザ光K1は、波長選択フィルタ7aの第1入力部I₁に角度 θa で入射すると、屈折率N_pによって角度 $\theta' a$ で透過して、全反射膜7b（反射部）で θs （ $\theta a + \text{クサビ角度} \psi$ ）の角度で反射し、第2のレーザ光K2の入射位置に達する。

【0200】

一方、第2のレーザ光K2は、波長選択フィルタ7aの第2入力部I₂に角度 θb で入射すると、屈折率N_pによって角度 $\theta' b$ で透過する。反射した第1のレーザ光K1が、波長選択フィルタ7aの第2入力部I₂に $\theta' b$ （ $\theta s + \text{クサビ角度} \psi$ ）で反射するので、第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2は合成される。合成されたレーザ光（K1+K2）は、反射防止膜7cの出力部Oを透過する。

【0201】

本実施形態例の光モジュールは、例えば、以下のような数値に設計することにより実施することが可能である。

【0202】

$\psi = 1^\circ$ 、 $\theta' a = 8^\circ$ 、 $\theta' b = 10^\circ$ 、 $N_p = 1.5$ 、 $\theta a = 12.050^\circ$ 、 $\theta b = 15.098^\circ$ 、第1レンズ4の光軸Cと第1のレーザ光K1との

なす角度 $\alpha_a = (\theta_a - \theta_b) / 2 = -1.524^\circ$ 、第1レンズの光軸Cと第2のレーザ光K2とのなす角度 $\alpha_b = (\theta_b - \theta_a) / 2 = 1.524^\circ$ 、第1レンズの焦点距離 $f_2 = 720 \mu\text{m}$ 、第1のストライプ9と第1レンズ4の光軸Cとの距離 $d_a = -\tan \alpha_a \cdot f_2 = 19.16 \mu\text{m}$ 、第2のストライプ10と第1レンズ4の光軸Cとの距離 $d_b = -\tan \alpha_b \cdot f_2 = -19.16 \mu\text{m}$ 、第1のレーザ光K1の入射位置での光合成部材7の厚さ $t = 1 \text{mm}$ 、第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2の入射位置の間隔 $\Delta y \div 2 (\tan \theta_a + \psi) t \div 0.462 \text{mm}$ 、第1レンズ4の焦点位置から光合成部材7端面までの光軸上の距離 $D \div \Delta y / (\theta_b - \theta_a) = 8.7 \text{mm}$ 、 $\lambda_a = 1480 \text{nm}$ 、 $\lambda_b = 1460 \text{nm}$ ($\lambda_x(\theta_b) = 1470 \text{nm}$ 、 $\lambda_x(\theta_a) = 1486.5 \text{nm}$ 、入射角0度での遮断波長 $\lambda_{x0} = 1522.6 \text{nm}$ とする)

第16の実施形態例によれば、半導体レーザ素子2から出射された複数のレーザ光を別焦点に集光させる第1レンズ4を用いているので、ビーム径及び像倍率が小さくなり、位置や角度のトレランスがゆるやかになる。これは、本実施形態例に限らず、集光光学系としての第1レンズ4を用いた場合の共通の効果である。

【0203】

次に、半導体レーザ素子2から出射したレーザ光が光ファイバに結合する場合の結合効率をガウシアンビーム近似にて考察する。この場合、半導体レーザ素子2から出射され、第1レンズ4により投影されるビームと、光ファイバ8から出射され第2レンズ16により投影されるビームとの結合を考えればよい。各々の投影ビームのモードフィールド半径が同一になるように、各々のレンズ4、16の焦点距離を選定する。

【0204】

図32において、 f_2 は第1レンズ4の焦点距離、 f_3 は第2レンズ16の焦点距離、 w_{LD} は第1レンズ4の焦点距離 f_2 だけ離れている地点pのモードフィールド半径、 w_f は、第2レンズ16の焦点距離 f_3 だけ離れている地点qのモードフィールド半径、第1レンズ4及び第2レンズ16の焦点位置の間隔である。

【0205】

像倍率 $M \doteq w f / w LD = f 2 / f 3$ となるので、例えば、 $w f = 5 \mu m$ 、 $w LD = 1.7 \mu m$ 、 $f 2 = 720 \mu m$ とすると、 $f 3 = 2100 \mu m$ となる。

【0206】

このとき、半導体レーザ素子2及び光ファイバ8から出射され、第1レンズ4、第2レンズ16により投影されたモードフィールド半径は、 $198 \mu m$ である。このときの軸ずれトレランスは、 $200 \mu m$ の場合にはほぼ等しい。

【0207】

特に、 $\Delta \theta = 0.013^\circ$ と角度較差が厳しいレーザ側の2つのビームを合波するためには、各々ビームの角度較差を 0.013° 程度にする必要がある。このために、くさび角 $\psi = 1 + 0.003^\circ$ 、 $d a = -d b = 19.16 \pm 0.03 \mu m$ 、 $f 2 = 720 \pm 0.7 \mu m$ となるように、各々の部品を作製すればよい。これにより、ストライプ9、10と光ファイバ8との結合効率を、それぞれ80%以上にすることが可能となる。

(第17の実施形態例)

図29は、本発明の第17の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0208】

図29に示すように、第17の実施形態例に係る半導体レーザモジュールは、間隔を隔てて形成された複数(図29の例では3つ)のストライプ9a、9b、9cを有し、各ストライプ9a、9b、9cの前側端面から複数のレーザ光K1、K2、K3を出射する半導体レーザ素子2と、半導体レーザ素子2から出射された複数のレーザ光を別焦点に集光させる第1レンズ4と、第1レンズ4を通過した複数のレーザ光を光合成する光合成部材7と、光合成手段7から出射されるレーザ光を受光し外部に送出する光ファイバ8とを有する。

【0209】

半導体レーザ素子2のストライプ9a、9b、9cは前述した回折格子75が設けられ、ストライプ9a、9b、9cから各々異なる波長でレーザ光が出射される。

【0210】

また、図30に示すように、クサビ形プリズムの出射側表面には、全ての波長の光を反射する全反射膜（反射部）7bと、反射を防止する反射防止膜（出力部）7cが形成されている。

【0211】

第16の実施形態例によれば、レーザ光K1の波長を λ_a 、波長選択フィルタ7aへの入射角度を θ_a に設定し、レーザ光K2の波長を λ_b 、波長選択フィルタ7aへの入射角度を θ_b に設定し、レーザ光K3の波長を λ_c 、波長選択フィルタ7aへの入射角度を θ_c に設定する。

【0212】

第1のレーザ光K1は、波長選択フィルタ7aの第1入力部I₁に角度 θ_a で入射すると、屈折率N_pによって角度 θ'_a で透過して、全反射膜7b（反射部）で θ_s （ $\theta_a + \text{クサビ角度}\phi$ ）の角度で反射し、第2のレーザ光K2の第1入力部I₁に達する。

【0213】

一方、第2のレーザ光K2は、波長選択フィルタ7aの第2入力部I₂に角度 θ_b で入射すると、屈折率N_pによって角度 θ'_b で透過する。反射した第1のレーザ光K1が、波長選択フィルタ7aに θ'_b （ $\theta_s + \text{クサビ角度}\phi$ ）で反射するので、第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2は合成される。合成されたレーザ光（K1+K2）は、全反射膜7bで θ_t （ $\theta'_b + \text{クサビ角度}\phi$ ）の角度で反射し、第3のレーザ光K2の第3入力部I₃に達する。

【0214】

一方、第3のレーザ光K3は、波長選択フィルタ7aの第3入力部I₃に角度 θ_c で入射すると、屈折率N_pによって角度 θ'_c で透過する。反射した合成レーザ光（K1+K2）が、波長選択フィルタ7aの第3入力部I₃に θ'_c （ $\theta_t + \text{クサビ角度}\phi$ ）で反射するので、第3のレーザ光K3及び合成レーザ光（K1+K2）は合成される。合成されたレーザ光（K1+K2+K3）は、反射防止膜7cを透過する。

【0215】

第16の実施形態例では、第1のレーザ光K1の光路補正を行うために、光路補正プリズム96が光合成部材7の前側に配置されている（図31参照）。

【0216】

光路補正プリズム96により、ガウシアンビームの軸ずれ（ Δx 、 Δy 、 $\Delta \theta$ 、 Δz ）を補正することができる。

【0217】

ここで、光路補正プリズム96の光軸方向の長さをL、入射角を θ_p 、透過した角度を $\theta_{p'}$ 、屈折率をNcとすると、

$$\sin \theta_p = N_c \sin \theta_{p'}$$

$$\Delta y = L \cdot \tan(\theta_p - \theta_{p'}) / (1 - \tan(\theta_p - \theta_{p'}) \tan \theta_p) \\ \div L \theta \text{ (rad)} \cdot (1 - 1/N) \text{ となる。}$$

【0218】

また、 $\Delta z \div (1 - 1/N_c) L$ となる。

【0219】

Δx については、光路補正プリズム96により、第1のレーザ光K1の入射位置を補正した。また、光路補正プリズム96を回転することにより入射位置 Δy_1 の微調整を行うことができる。 Δy_2 については、光路補正プリズム96を前後に動かすことにより調整できる。

【0220】

$\Delta \theta$ については、 $\psi = 1 \pm 0.05^\circ$ 、 d_a 、 d_c の較差を $\pm 0.1 \mu m$ とすることで、無調整にて低損失での合波が可能となる。

【0221】

Δz については、クサビ形プリズムで複数回反射が生じるため、ビームの集光点がレーザ光毎に異なる。光路補正プリズム96を挿入しないと、第1のレーザ光K1と第3のレーザ光K3の光路差が約2.5mm生じる。

【0222】

本実施形態例のように、光路補正プリズム96を挿入することにより、光路長差をほぼ完全に補正できる。同様に、第2のレーザ光K2に対しても光路補正プリズム96を挿入して光路長補正を行ってもよい。

【0223】

本実施形態例によれば、レーザ光の光路上に光路補正プリズム96を挿入しているため、各部品の較差を比較的ゆるくしても、各レーザ光の光ファイバ8への光結合を約80パーセント以上とすることが可能である。

【0224】

なお、本実施形態例では、第1レンズ4により複数のレーザ光の間隔が広げられ、各レーザ光が重なることなく独立しているため、光路補正プリズム96を挿入することができる。

【0225】

本実施形態例の光モジュールは、例えば、以下のような数値に設計することにより実施することが可能である。

【0226】

第2のレーザ光K2の光路と第1レンズ4の中心軸Cは一致する。

【0227】

$\phi = 1^\circ$ 、 $\theta' a = 8^\circ$ 、 $\theta' b = 10^\circ$ 、 $\theta' C = 12^\circ$ 、 $Np = 1.5$ 、 $\theta a = 12.050^\circ$ 、 $\theta b = 15.10^\circ$ 、 $\theta c = 18.17^\circ$ 、第1レンズ4の光軸Cと第1のレーザ光K1とのなす角度 $\alpha a = \theta a - \theta b = -3.05^\circ$ 、第1レンズの光軸Cと第3のレーザ光K3とのなす角度 $\alpha c = \theta c - \theta a = 3.07^\circ$ 、第1レンズの焦点距離 $f_2 = 720 \mu m$ 、第1のストライプ9aと第1レンズ4の光軸Cとの距離 $d a = -\tan \alpha a \cdot f_2 = -38.4 \mu m$ 、第3のストライプ9cと第1レンズ4の光軸Cとの距離 $d c = -\tan \alpha c \cdot f_2 = 38.6 \mu m$ 、第1のレーザ光K1の入射位置での光合成部材7の厚さ $t = 1 mm$ 、第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2の入射位置の間隔 $\Delta y_1 \doteq 2 (\tan \theta a + \phi) t \doteq 0.462 mm$ 、第2のレーザ光K2及び第3のレーザ光K3の入射位置の間隔 $\Delta y_2 \doteq 2 (\tan \theta a + 2 \phi / \cos^2 \theta a + \phi) t \doteq 0.535 mm$ 、第1レンズ4の焦点位置から光合成部材7端面までの光軸上の距離 $D \doteq \Delta y_2 / (\theta c - \theta b) (rad) = 10.0 mm$ 、 $\lambda a = 1490 nm$ 、 $\lambda b = 1470 nm$ 、 $\lambda c = 1450 nm$ ($\lambda x (\theta c) = 1460 nm$ 、 $\lambda x (\theta b) = 1483.57 nm$ 、 $\lambda x (\theta a) = 1502.77 nm$ 、入射角0度での遮断波

長 $\lambda_0 = 1536.62 \text{ nm}$ とする)。

【0228】

また、光路補正プリズム 96 では、 $\Delta y = D \cdot (\theta_b - \theta_a) \text{ (rad)} - \Delta y_1 = 0.070 \text{ mm}$ 、 $L = 3.5 \text{ mm}$ 、 $N_c = 3.4$ (シリコン) とすると、プリズム入射角 $\theta \doteq 1.25^\circ$ 、光路長の短縮 $\Delta z \doteq (1 - 1/N_c) L \doteq 2.5 \text{ mm}$ である。

【0229】

上記第 16 及び第 17 の実施形態例を一般化すると、半導体レーザ素子 2 の第 1 ～ n (n は 2 以上の整数) のストライプからそれぞれ第 1 ～ 第 n 波長の光を出射した場合、光合成部材 7 は、第 1 ～ 第 n 波長の光をそれぞれ入射する第 1 ～ 第 n 入力部と、光を全反射する反射部と、出力部とを備えたものであり、各第 i (i は 2 ～ n の全ての整数) 入力部と反射部は、第 i - 1 入力部から光合成手段内に入射した第 i - 1 光が反射部において第 i 入力部に向かって反射され、第 i 入力部において第 i 波長の光の進行方向に反射されて、第 i 波長の光と合成されるように構成され、合成された第 1 ～ 第 n 波長の光は出力部を介して光ファイバに結合される。

(第 18 の実施形態例)

第 18 の実施形態例は、上述した第 1 ～ 第 11 の実施形態例に示した半導体レーザモジュールをラマン増幅器に適用したものである。

【0230】

図 33 は、本発明の第 12 の実施形態例であるラマン増幅器の構成を示すブロック図である。このラマン増幅器は、例えば WDM 通信システムに用いられる。図 33 に示すように、本発明の第 12 の実施形態例に係るラマン増幅器 48 は、信号光が入力される入力部 49 と、信号光が出力される出力部 50 と、入力部 49 と出力部 50 の間で信号光を伝送する光ファイバ (増幅用ファイバ) 51 と、励起光を発生させる励起光発生部 52 と、励起光発生部 52 によって発生された励起光と光ファイバ (増幅用ファイバ) 51 に伝送される信号光とを合波する WDM カプラ 53 とを有する。入力部 49 と WDM カプラ 53 との間及び出力部 50 と WDM カプラ 53 との間には、入力部 49 から出力部 50 への方向の信号光

だけを透過させる光アイソレータ 54 がそれぞれ設けられている。

【0231】

励起光発生部 52 は、互いに波長帯の異なるレーザ光を出射する本発明の実施形態例に係る複数の半導体レーザモジュール M と、半導体レーザモジュール M から出射されたレーザ光を合成する WDM カプラ 55 とを有する。

【0232】

半導体レーザモジュール M から出射された励起光は、偏波保存ファイバ 55a を介して WDM カプラ 55 によって合成され、励起光発生部 52 の出射光となる。

【0233】

励起光発生部 52 で発生した励起光は、WDM カプラ 53 により光ファイバ 51 に結合され、一方、入力部 49 から入力された信号光は、光ファイバ 51 で励起光と合波されて増幅され、WDM カプラ 53 を通過し、出力部 50 から出力される。

【0234】

光ファイバ 51 内において増幅された信号光（増幅信号光）は、WDM カプラ 53 及び光アイソレータ 54 を介してモニタ光分配用カプラ 56 に入力される。モニタ光分配用カプラ 56 は、増幅信号光の一部を制御回路 57 に出射し、残りの増幅信号光を出射レーザ光として出力部 50 から出力される。

【0235】

制御回路 57 は、入力された一部の増幅信号光をもとに各半導体レーザモジュール M のレーザ出射状態、例えば光強度を制御し、光増幅の利得帯域が平坦な特性となるようにフィードバック制御する。

【0236】

このラマン増幅器 48 では、ストライプに回折格子 75 が設けられた半導体レーザ素子が内蔵された半導体レーザモジュールを用いた場合には、FBG の使用を削減することができる。その結果、ラマン増幅器の小型軽量化とコスト低減を実現することができる。

【0237】

また、FBGを用いた半導体レーザモジュールに比して相対強度雑音 (RIN) を低減することができるので、ラマン利得の揺らぎを抑えることができ、安定したラマン増幅を行うことができる。

【0238】

また、FBGを用いた半導体レーザモジュールに比して光軸合わせが容易であり、組立性が向上し、共振器内に機械的な光結合がないため、この点からも、ラマン増幅の安定性、信頼性を高めることができる。

【0239】

さらに、ストライプに回折格子75が設けられた半導体レーザ素子では、複数の発振モードを有しているため、誘導ブリルアン散乱を発生させずに、高出力の励起光を発生することができるので、安定し、かつ高いラマン利得を得ることができる。

【0240】

また、図33に示したラマン増幅器は、後方励起方式であるが、上述したように、半導体レーザモジュールが安定した励起光を出射するため、前方励起方式であっても、双方向励起方式であっても、安定したラマン増幅を行うことができる。

【0241】

この図33に示したラマン増幅器は、上述したようにWDM通信システムに適用することができる。図34は、図33に示したラマン増幅器を適用したWDM通信システムの構成を示すブロック図である。

【0242】

図34において、複数の送信機87から送出された波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ の光信号は、光合波器88によって合波され、1つの光ファイバ89に集約される。この光ファイバ89の伝送路上には、図33に示したラマン増幅器に対応した複数のラマン増幅器90が距離に応じて配置され、減衰した光信号を増幅する。この光ファイバ90上を伝送した信号は、光分波器91によって、複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ の光信号に分波され、複数の受信機92に受信される。なお、光ファイバ89上には、任意の波長の光信号を付加し、取り出したりするADM93 (Add/DropM

ultiplexer) が挿入される場合もある。

【0 2 4 3】

本発明は、上記実施の形態に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載された技術的事項の範囲内において、種々の変更が可能である。

【0 2 4 4】

前記の実施の形態に係る半導体レーザモジュールMでは、半導体レーザ素子2とホルダ部材14とは同一の冷却装置20によって冷却されるが、別個の冷却装置を用いて、半導体レーザ素子2とホルダ部材14とを独立に温度制御してもよい。

【0 2 4 5】

また、偏光回転手段としては、半波長板6を用いることを示したが、例えばファラデー素子を用いて偏光面を回転させてもよい。この場合、ファラデー素子をコイルの内部に配置し、ファラデー素子に印加する磁界強度をコイルに流す電流の大きさによって可能とすれば、レーザの波長のばらつきや、温度のばらつきによる偏光面の回転角のばらつきを、コイルに流す電流の大きさを調整することによって個々に補償することが可能となる。

【0 2 4 6】

また、本発明の実施形態例の半導体レーザモジュールは、ラマン増幅用の励起光源に用いるだけでなく、例えば、 $0.98\mu\text{m}$ などのEDFA励起用光源として用いることができるのは明らかである。さらに、本発明の実施形態例の半導体レーザモジュールを信号光源として用いることも可能である。

【0 2 4 7】

また、本半導体レーザ素子2に形成されるストライプの数は、2本又は3本に限定されず、4本以上あってもよい。

【0 2 4 8】

【発明の効果】

本発明によれば、レーザ光を出射させる複数のストライプを備えた1個の半導体レーザ素子と、複数のレーザ光を分離する単一の第1レンズを用いているので、半導体レーザ素子や第1レンズの位置決め時間が短くなる。その結果、半導体

レーザモジュールの製造時間を短縮化できる。

【0249】

また、従来は2つの半導体レーザ素子からそれぞれ全く異なる軸方向に光が出射されるため、それぞれの軸方向でのパッケージの反り等を考慮してモジュールを設計しなければ、環境温度の変化等によって生じたパッケージの反りによる光出力変動を抑制できなかった。これに対し、本発明によれば、1個の半導体レーザ素子から出射される複数の光は略同じ方向に伝搬されるため、パッケージの反りの影響を1方向においてのみ抑制することにより、光ファイバから出射される光出力の安定化を図ることができる。

【0250】

また、1個の半導体レーザ素子から複数のレーザ光を出射することにより、これらの光はパッケージの反り等に対して、光ファイバとの結合効率が同じ傾向で変動する。従って、温度変動等があった場合でも光ファイバから出射される光の偏光度が安定化する。

【0251】

また、1つの半導体レーザ素子を用いるので、半導体レーザ素子から発生した熱を冷却するためのペルチェモジュール等の冷却装置を小型化でき、低消費電力化を図ることができる。

【0252】

また、半導体レーザ素子から出射された複数のレーザ光を別焦点に集光させる第1レンズを用いているので、ビーム径及び像倍率が小さくなり、位置や角度のトレランスがゆるやかになる。

また、半導体レーザ素子の各ストライプに回折格子が設けられているので、回折格子を任意に組み合わせて各ストライプを形成することにより、半導体レーザモジュールから出力される光の波長設定の自由度が増加する。

【0253】

本発明の半導体レーザモジュールをラマン増幅用励起光源として用いると、次のような効果がある。

半導体レーザ素子の各ストライプに回折格子が設けられているので、波長が安

定化され、ファイバグレーティングを用いた半導体レーザモジュールに比べて、相対強度雑音が低減され、特に、前方励起のラマン増幅器に用いた場合にノイズの少ないラマン増幅を行うことができる。

【0254】

また、共振器が物理的に分離されていないため、機械的振動などによってレーザの発振特性が変化しにくくなり、安定したレーザ光を信頼性高く出力することができ、ラマン増幅器に用いた場合に安定かつ信頼性の高いラマン増幅を行うことができる。

【0255】

また、半導体レーザ素子内の回折格子によって波長ロックを行うようにしているので、出力されたレーザ光を導く光ファイバからの反射戻り光の入射を防ぐための光アイソレータの組み込みが容易になる。

【0256】

その他、本発明には次のような効果がある。

【0257】

1個の半導体レーザ素子で波長合成を行うことができる。

【0258】

また、わずかに波長のずれた複数のストライプを設けることにより、合波されたスペクトルの幅が広がり、SBSの発生を抑制したり、更なるDOP低減を図ることが容易となる。

【0259】

また、光ファイバとして偏波保存ファイバを用い、その偏波面が半導体レーザ素子の偏波面と45度ずれて結合される場合には、更なるDOP低減を効果的に行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

(A)は本発明の第1の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を示す側面断面図、(B)は半導体レーザ素子がヒートシンク上に固定して取り付けられている状態を示す側面図である。

【図 2】

本発明の第 1 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 3】

(A) はプリズムの構成を示す側面図、(B) はその平面図である。

【図 4】

(A) は偏波合成モジュールを示す平面図、(B) はその側面断面図、(C) はその正面図である。

【図 5】

ダブルストライプ型半導体レーザモジュールにおいて駆動電流 2 A (つまりストライプ 1 本あたり 1 A) を印加した時のスペクトルを示すグラフである。

【図 6】

ダブルストライプ型半導体レーザモジュールにおいて LD 駆動電流に対するファイバ出力を示すグラフである。

【図 7】

(A) 及び (B) は第 1 レンズの調芯工程を説明するための説明図である。

【図 8】

(A) ~ (C) は半導体レーザ素子の構成を説明するための説明図であり、図 8 (B) 及び (C) は図 8 (A) の a - a 線断面図である。

【図 9】

半導体レーザ素子の他の例を示す説明図である。

【図 1 0】

本発明の第 2 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 1 1】

本発明の第 3 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 1 2】

本発明の第 4 の実施形態例の偏波合成モジュールを示す分解斜視図である。

【図 13】

図 12 の偏波合成モジュールを示す側面断面図である。

【図 14】

本発明の第 5 の実施形態例の半導体レーザ素子を示す説明図である。

【図 15】

(A) ~ (C) は、本発明の第 6 の実施形態例の半導体レーザ素子の構成を説明するための説明図であり、図 15 (B) 及び (C) は、それぞれ図 15 (A) の b-b 線断面図、c-c 線断面図である。

【図 16】

本発明の第 6 の実施形態例の半導体レーザ素子の発振波長スペクトルと発振縦モードとの関係を示すグラフである。

【図 17】

(A) 及び (B) は、単一発振縦モードと複数発振縦モードとのレーザ光出力パワーの関係及び誘導ブリルアン散乱のしきい値を示す図である。

【図 18】

(A) ~ (C) は第 7 の実施形態例である半導体レーザ素子の構成を示す長手方向の縦断面図である。

【図 19】

本発明の第 8 の実施形態例である半導体レーザ素子の構成を示す長手方向の縦断面図である。

【図 20】

図 19 に示した半導体レーザ素子に設けられた回折格子の周期揺らぎを示す説明図である。

【図 21】

図 19 に示した半導体レーザ素子に設けられた回折格子の周期揺らぎを実現する変形例を示す説明図である。

【図 22】

本発明の第 11 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 2 3】

本発明の第 1 2 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 2 4】

本発明の第 1 3 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 2 5】

本発明の第 1 4 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 2 6】

本発明の第 1 5 の実施形態例に係るフォトダイオード（受光素子）の例を示す説明図である。

【図 2 7】

本発明の第 1 6 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 2 8】

波長選択フィルタ 7 a に入射したときの光透過率を示すグラフである。

【図 2 9】

本発明の第 1 7 の実施形態例に係る半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 3 0】

クサビ形プリズムの光合成部材を説明するための説明図である。

【図 3 1】

光路補正プリズムを説明するための説明図である。

【図 3 2】

ガウシャンビームの結合を説明するための説明図である。

【図 3 3】

本発明の第 1 2 の実施形態例であるラマン増幅器の構成を示すブロック図である。

【図 3 4】

図 2 3 に示したラマン増幅器を適用した WDM 通信システムの構成を示すブロック図である。

【図 3 5】

米国特許第 5 5 8 9 6 8 4 号公報に開示された従来の半導体レーザ装置を説明するための説明図である。

【符号の説明】

- K 1 : 第 1 のレーザ光
- K 2 : 第 2 のレーザ光
- M, M 1, M 2, M 3 : 半導体レーザモジュール
- 1 : パッケージ
- 1 a : フランジ部
- 1 b : 窓部
- 1 c : 蓋
- 2 : 半導体レーザ素子
- 3 : フォトダイオード
- 4 : 第 1 レンズ
- 5 : プリズム
- 6 : 半波長板 (偏光回転手段)
- 7 : 光合成部材
- 7 a : 第 1 の入力部
- 7 b : 第 2 の入力部
- 7 c : 出力部
- 8 : 光ファイバ
- 9 : 第 1 のストライプ
- 1 0 : 第 2 のストライプ
- 1 1 : チップキャリア
- 1 2 : フォトダイオードキャリア
- 1 3 : 第 1 のレンズ保持部材

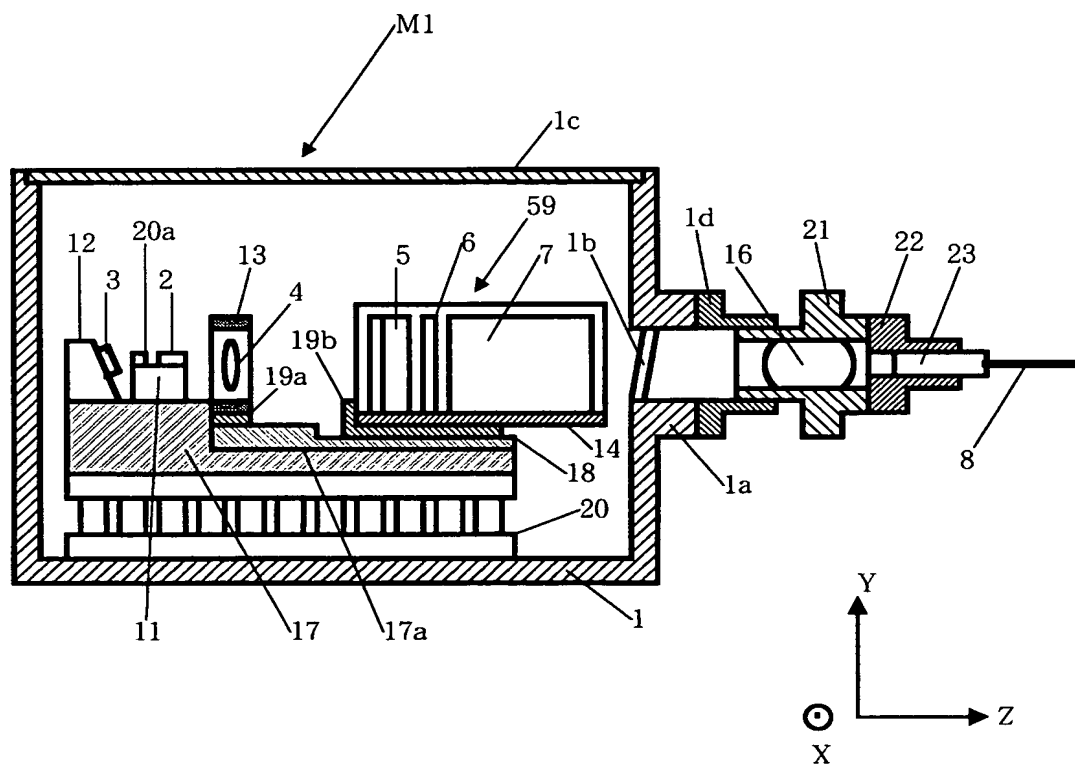
- 1 4 : ホルダ部材
- 1 5 : 光反射部
- 1 6 : 第 2 レンズ
- 1 7 : 第 1 の基台
- 1 8 : 第 2 の基台
- 1 9 a : 第 1 の支持部材
- 1 9 b : 第 2 の支持部材
- 2 0 : 冷却装置
- 2 0 a : サーミスタ
- 2 1 : 第 2 のレンズ保持部材
- 2 2 : スライドリング
- 2 3 : フェルール
- 2 4 : 基板
- 2 5 : 積層構造
- 2 6 : 下部電極
- 2 7 : 上部電極
- 2 8 : 低反射膜
- 2 9 : 高反射膜
- 3 0 : 下部クラッド層
- 3 1 : 下部 G r i n - S C H 層
- 3 2 : 活性層
- 3 3 : 上部 G r i n - S C H 層
- 3 4 : 上部クラッド層
- 3 5 : キャップ層
- 3 6 : p - I n P 層
- 3 7 : n - I n P 層
- 3 8 : 分離溝
- 3 9 : 絶縁膜
- 4 0 : 基板

- 4 1 : n 型下部クラッド層
- 4 2 : 活性層
- 4 3 : p 型上部クラッド層
- 4 4 : 絶縁層
- 4 5 : p - G a A s 層
- 4 6 : 上部電極
- 4 7 : 下部電極
- 4 8 : ラマン増幅器
- 4 9 : 入力部
- 5 0 : 出力部
- 5 1 : 光ファイバ
- 5 2 : 励起光発生部
- 5 3 : WDM カプラ
- 5 4 : 光アイソレータ
- 5 5 : WDM カプラ
- 5 6 : モニタ光分配用カプラ
- 5 7 : 制御回路
- 5 8 : ヒートシンク
- 5 9 : 偏波合成モジュール
- 6 0 : 偏波合成モジュール
- 6 1 : ホルダ部材
- 6 2 : 第 1 の調整シート
- 6 3 : 第 2 の調整シート
- 6 4 : 半波長板ホルダ
- 6 5 : ボトムカバー
- 6 6 : 第 1 のストッパー
- 6 7 : 第 2 のストッパー
- 6 8 : 半導体レーザ素子
- 6 9 : n - I n p 基板

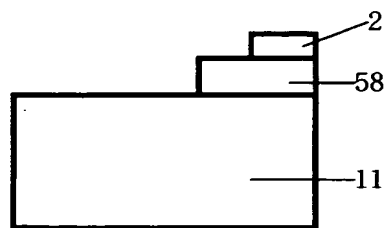
- 7 0 : n - I n P バッファ層
- 7 1 : G R I N - S C H - M Q W 活性層
- 7 2 : p - I n P スペーサ層
- 7 3 : p - I n P クラッド層
- 7 4 : I n G a A s P ギャップ層
- 7 5 : 回折格子
- 7 6 : p - I n P ブロッキング層
- 7 7 : n - I n P ブロッキング層
- 7 8 : P 側電極
- 7 9 : n 側電極
- 8 0 : 第 1 の反射膜
- 8 1 : 第 2 の反射膜
- 8 2 : 発振波長スペクトル
- 8 3 a ~ 8 3 c : 発振縦モード
- 8 4 a ~ 8 4 c : 半導体レーザ素子
- 8 5 : 半導体レーザ素子
- 8 5 : 半導体レーザ素子
- 8 6 : 半導体レーザ素子
- 8 7 : 送信機
- 8 8 : 光合波器
- 8 9 : 光ファイバ
- 9 0 : ラマン増幅器
- 9 1 : 光分波器
- 9 2 : 受信機
- 9 3 : A D M
- 9 4 : 光アイソレータ
- 9 5 : レンズ
- 9 6 : 光路補正プリズム

【書類名】 図面

【図 1】

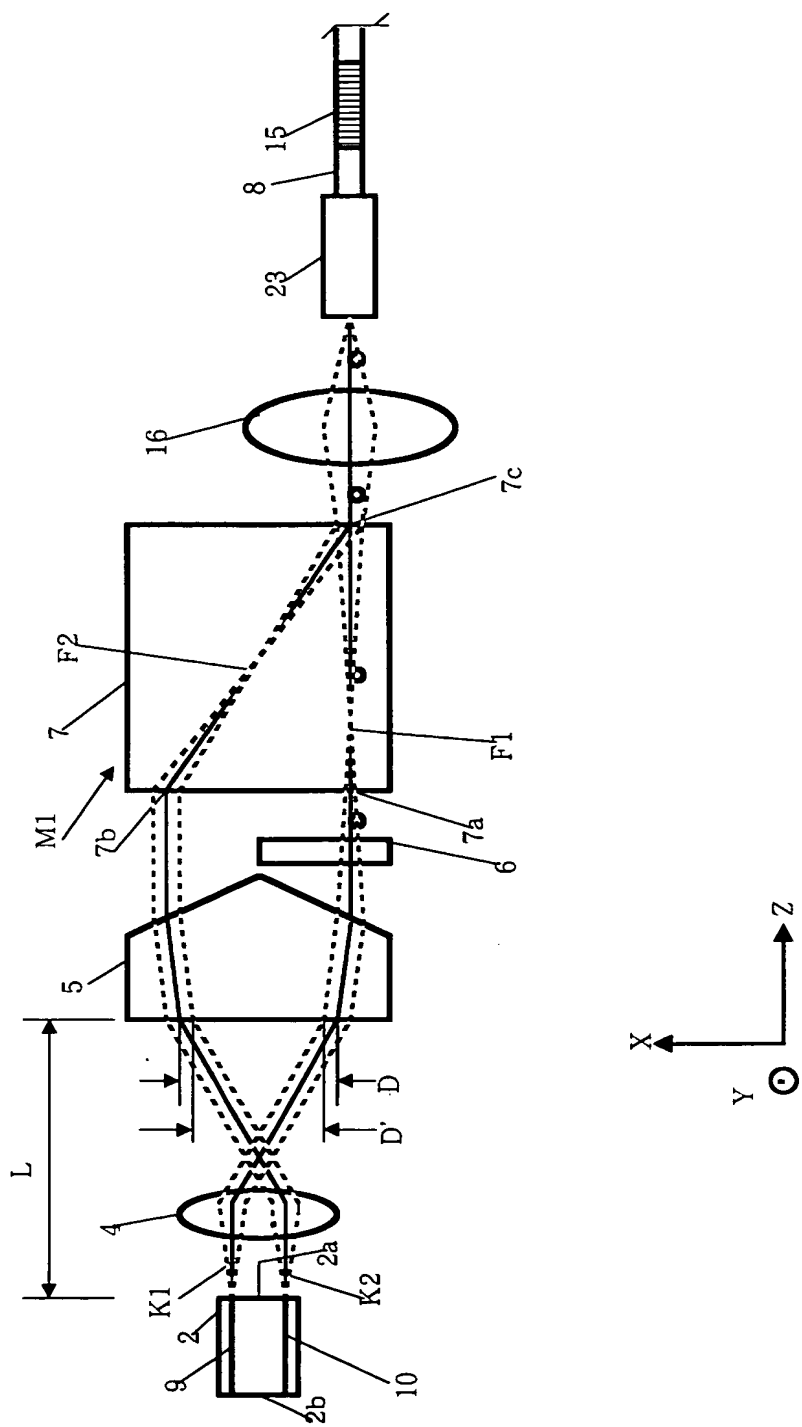


(A)

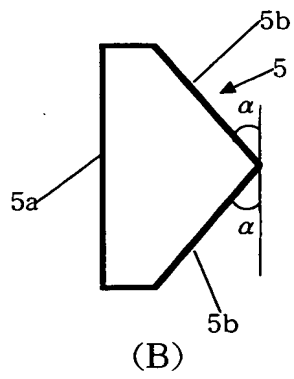
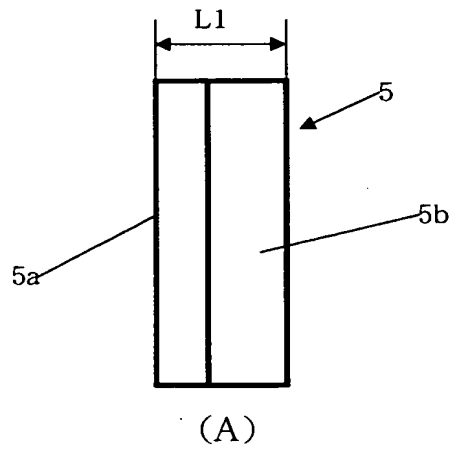


(B)

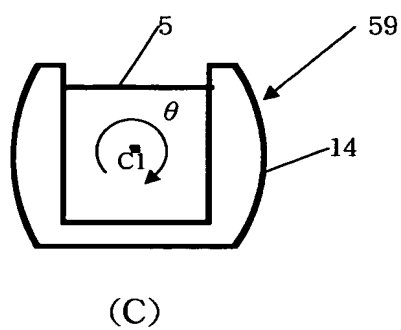
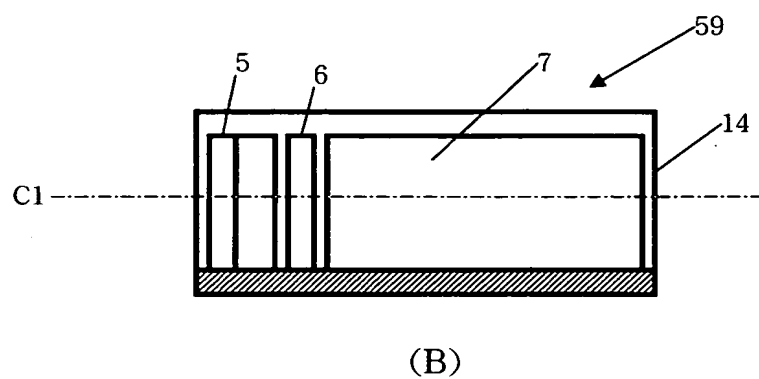
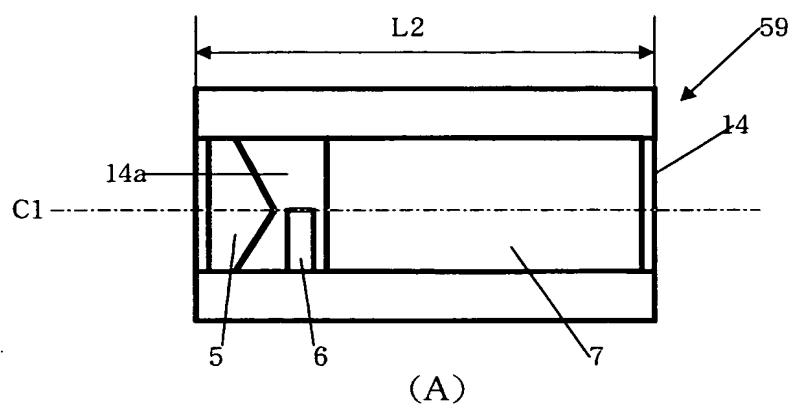
【図 2】



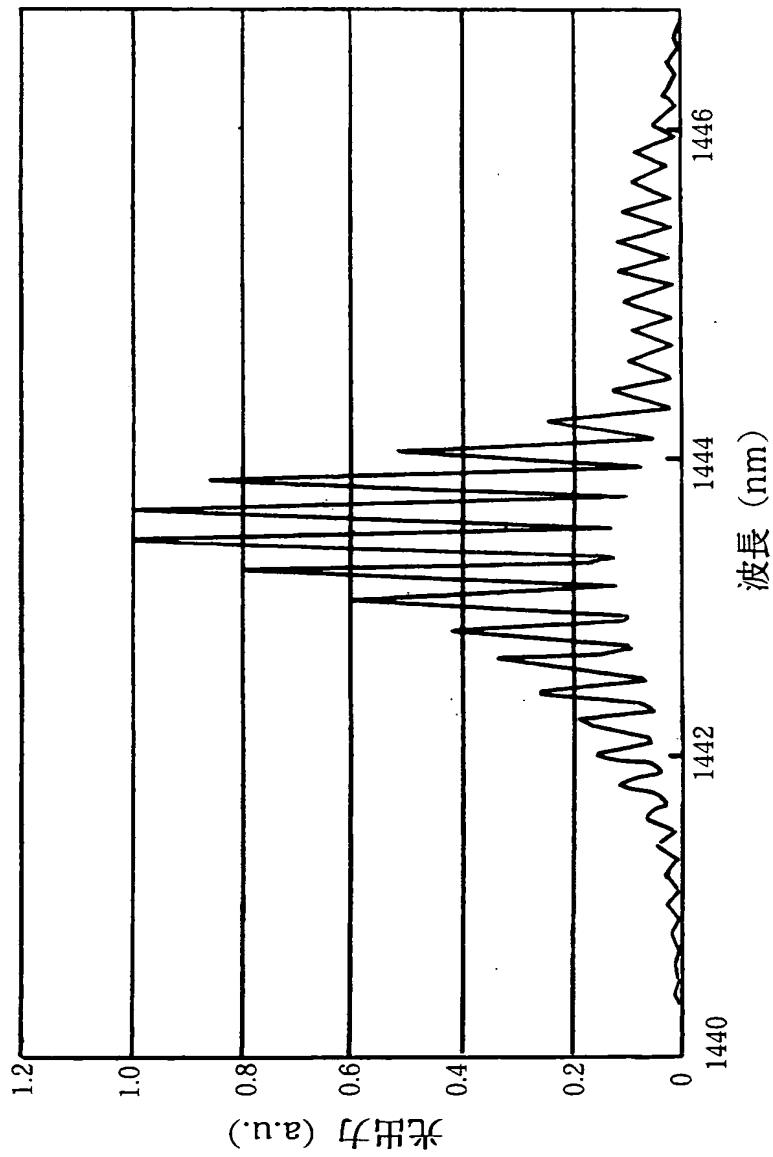
【図 3】



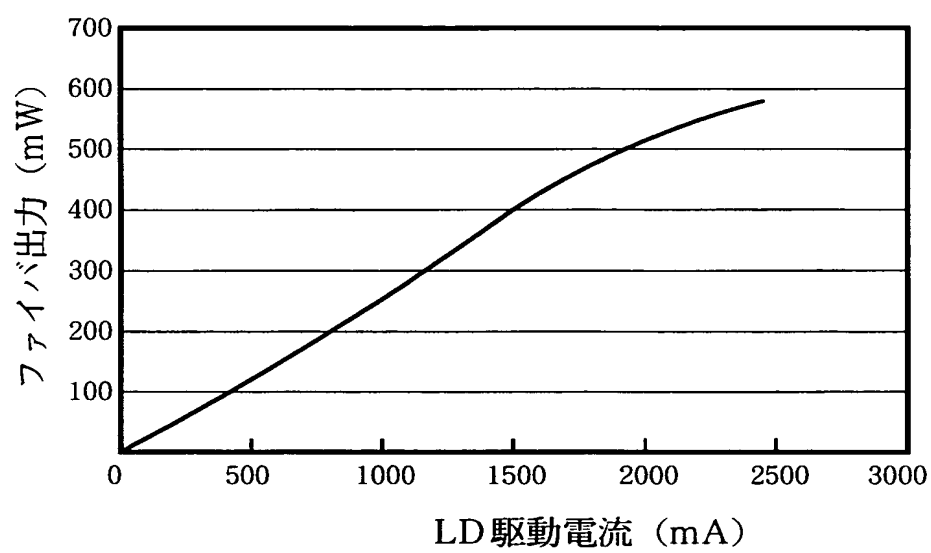
【図 4】



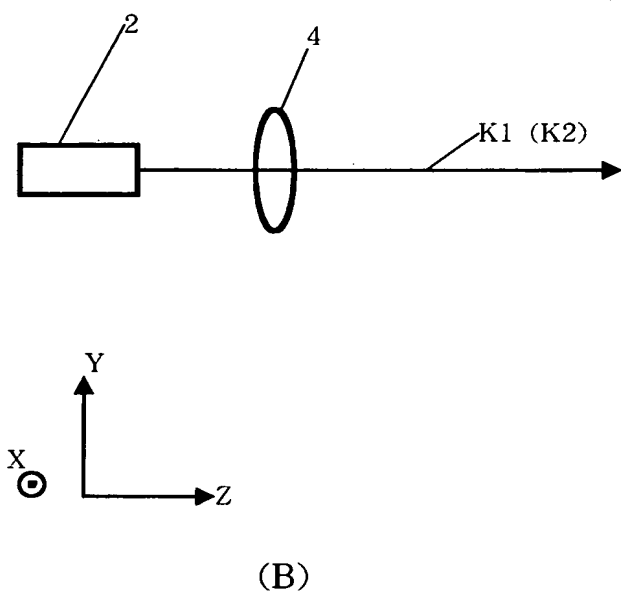
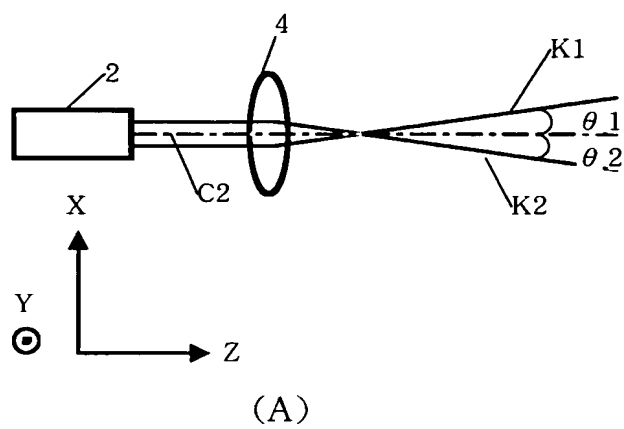
【図 5】



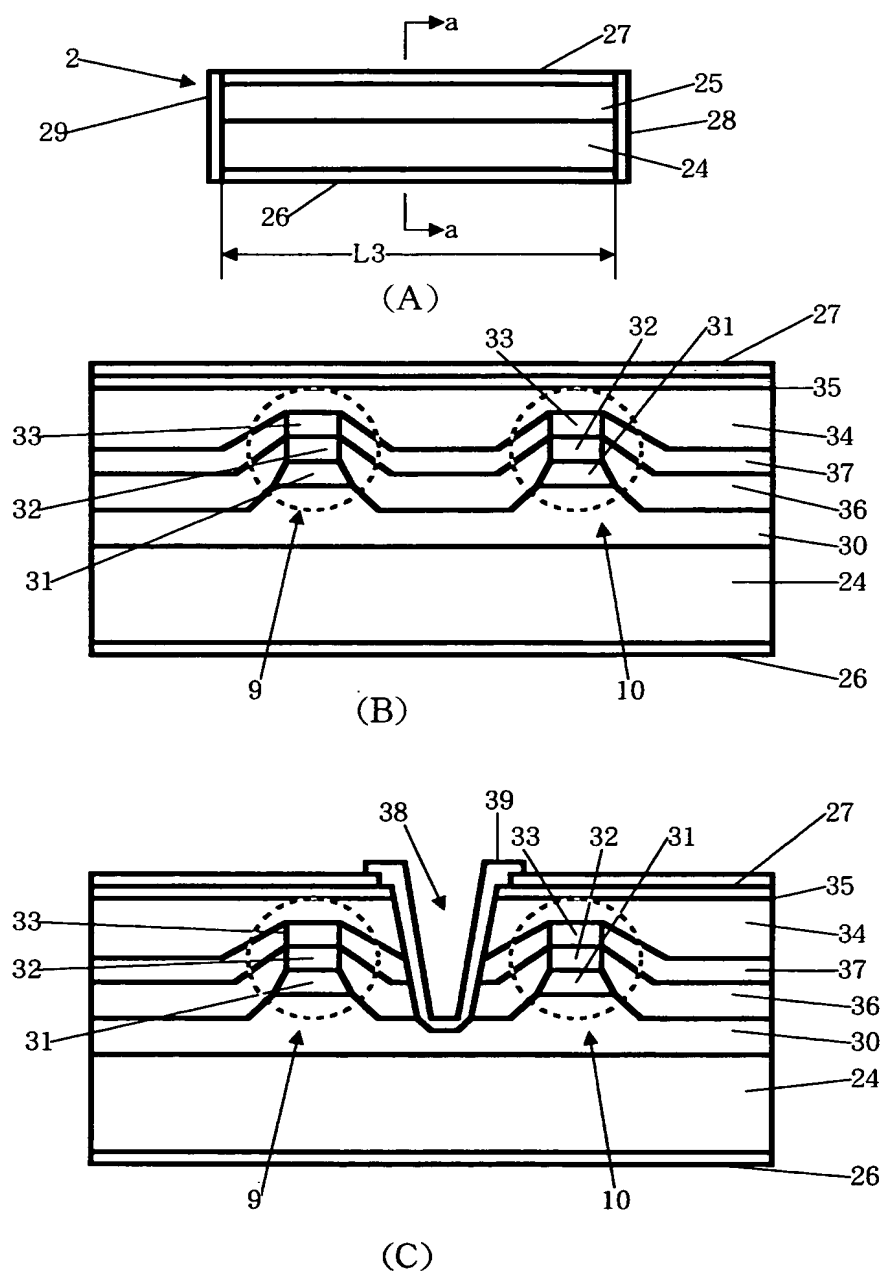
【図 6】



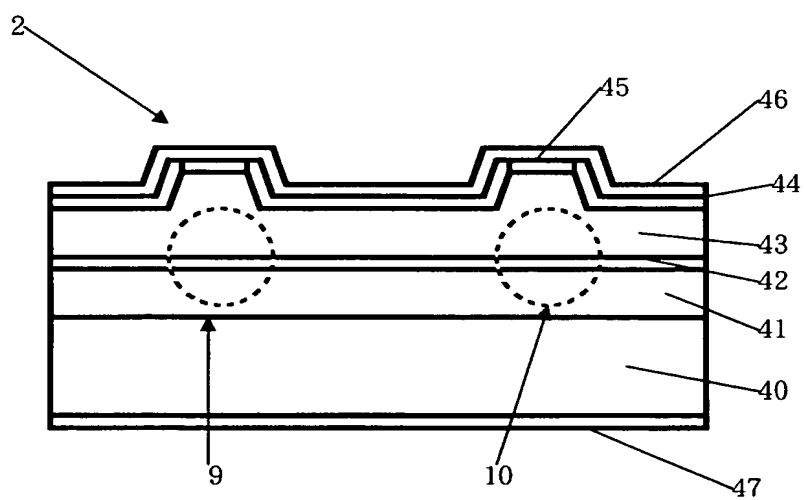
【図 7】



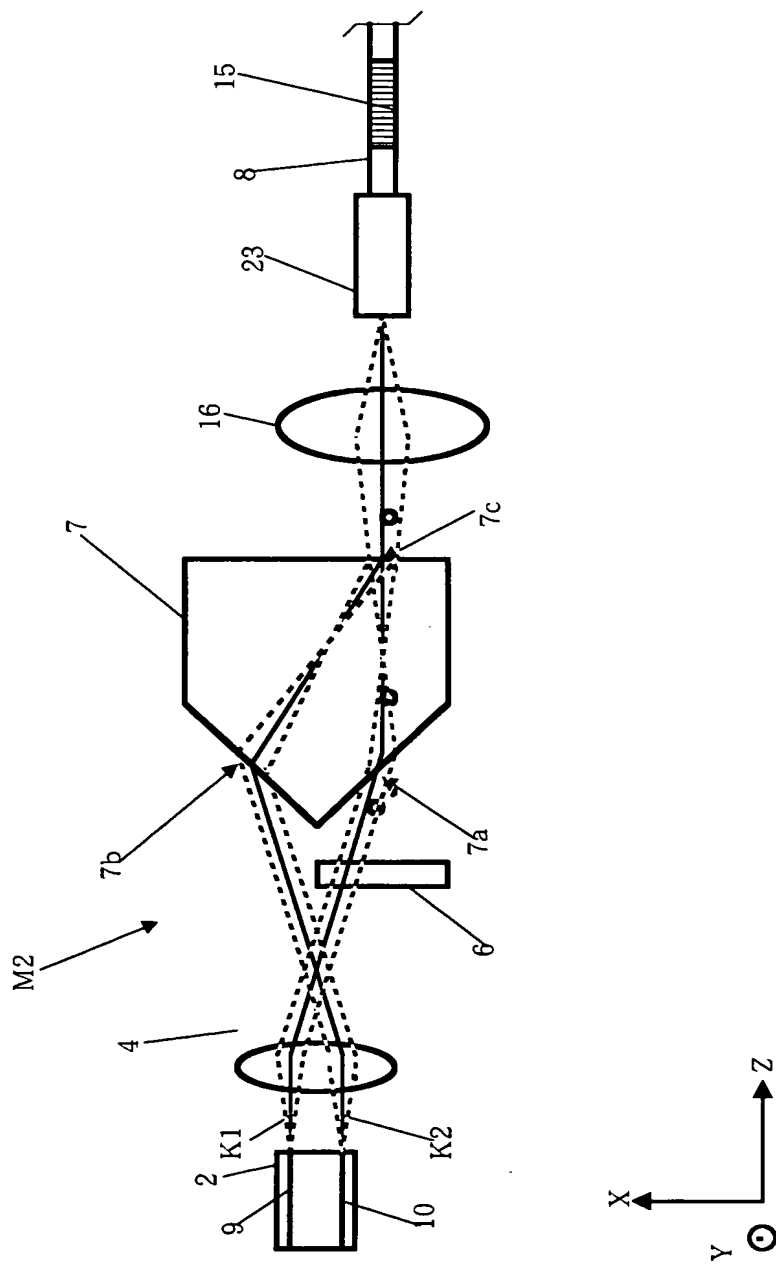
【図 8】



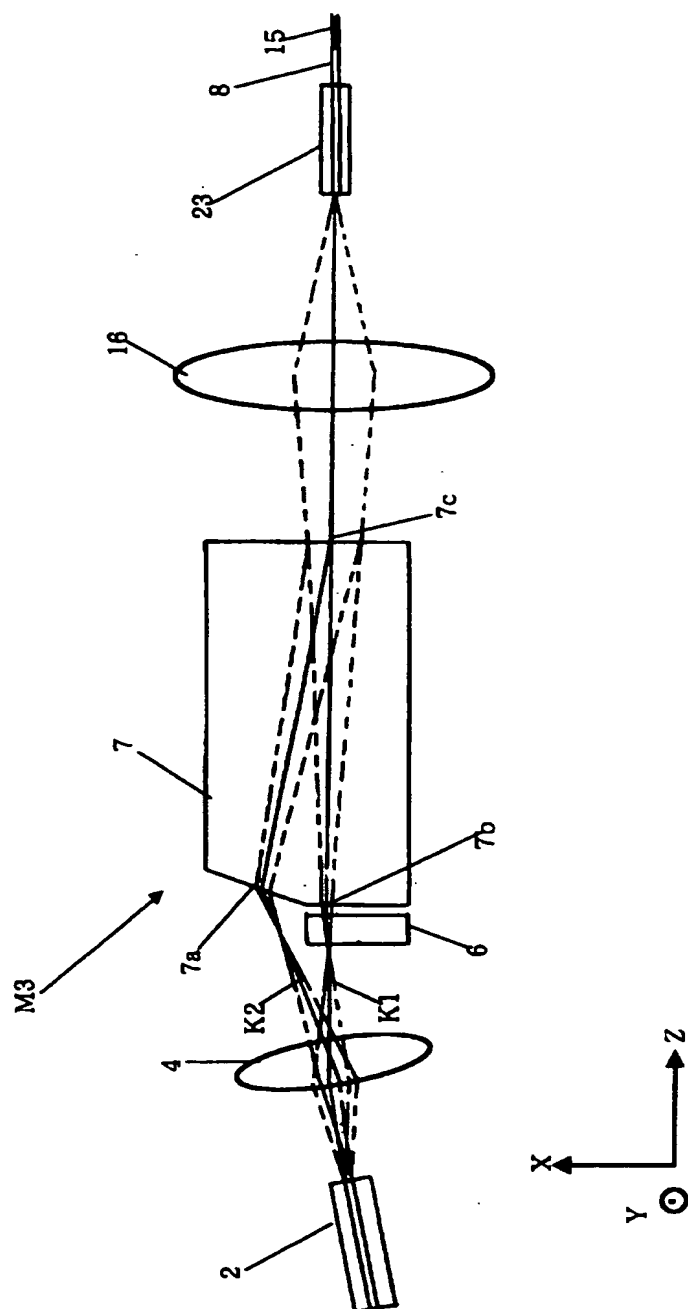
【図 9】



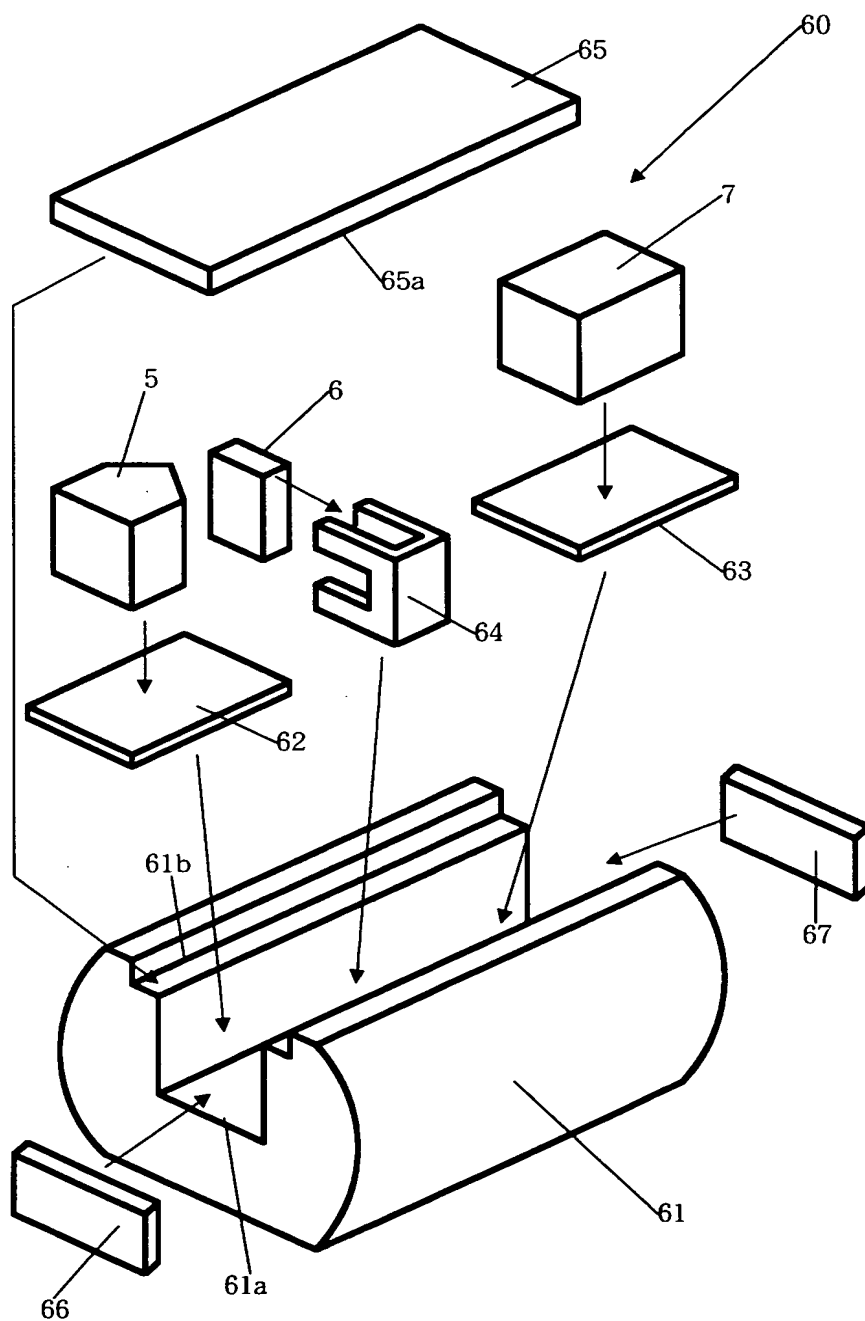
【図 10】



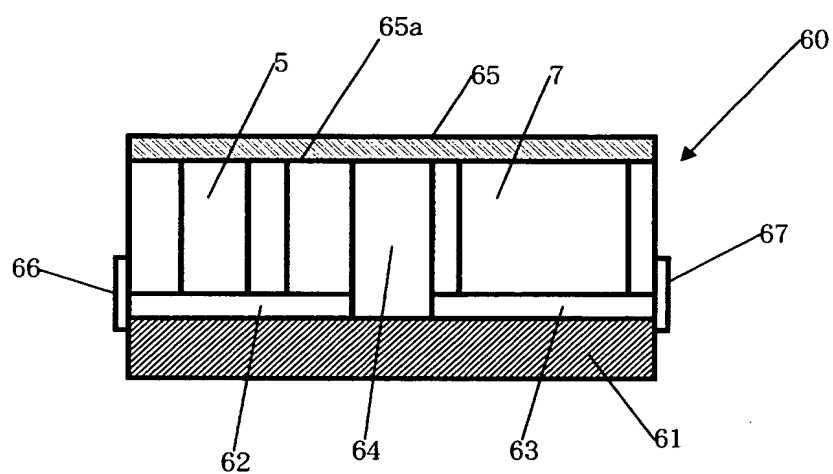
【図 11】



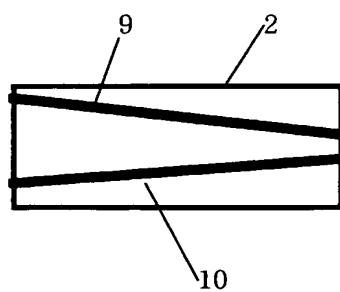
【図 12】



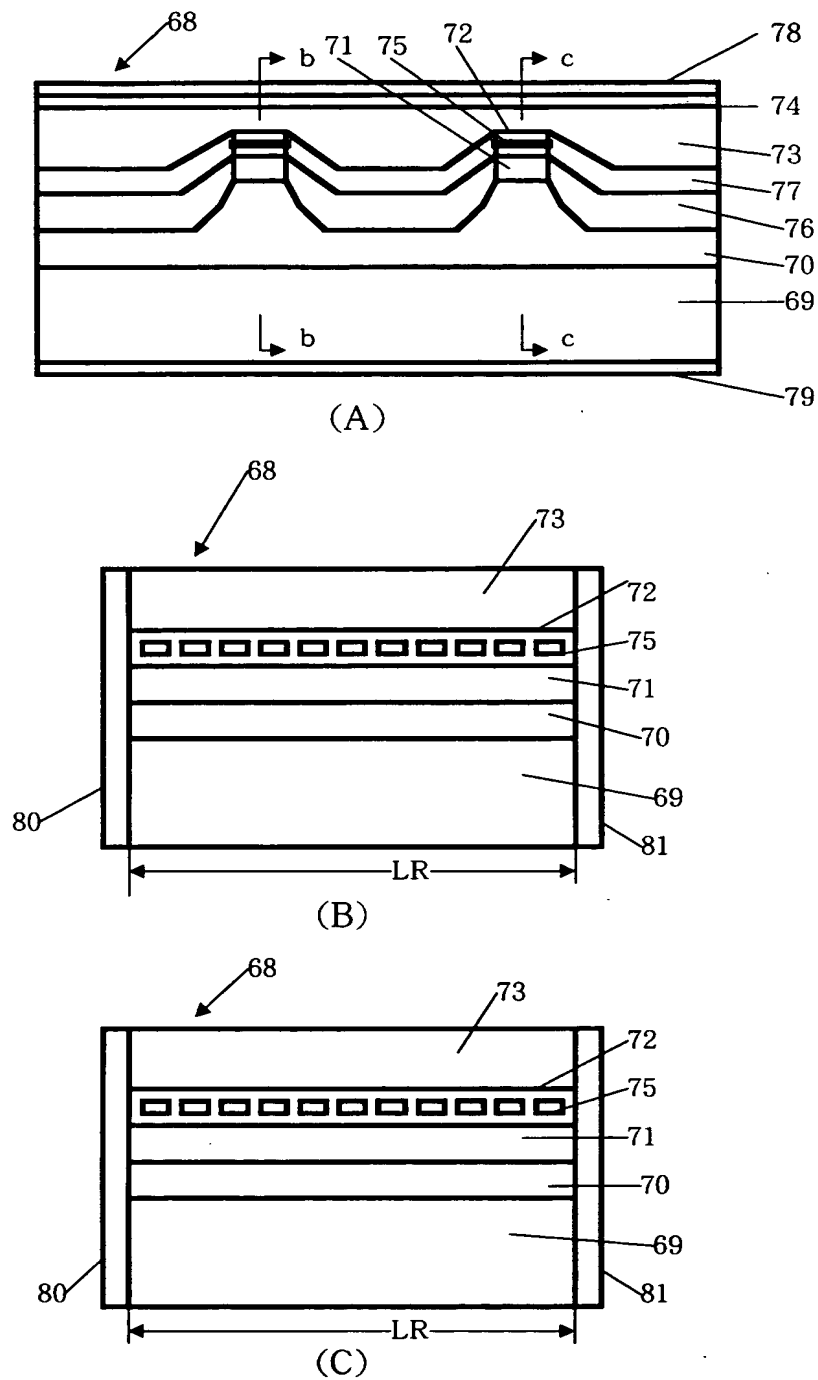
【図 13】



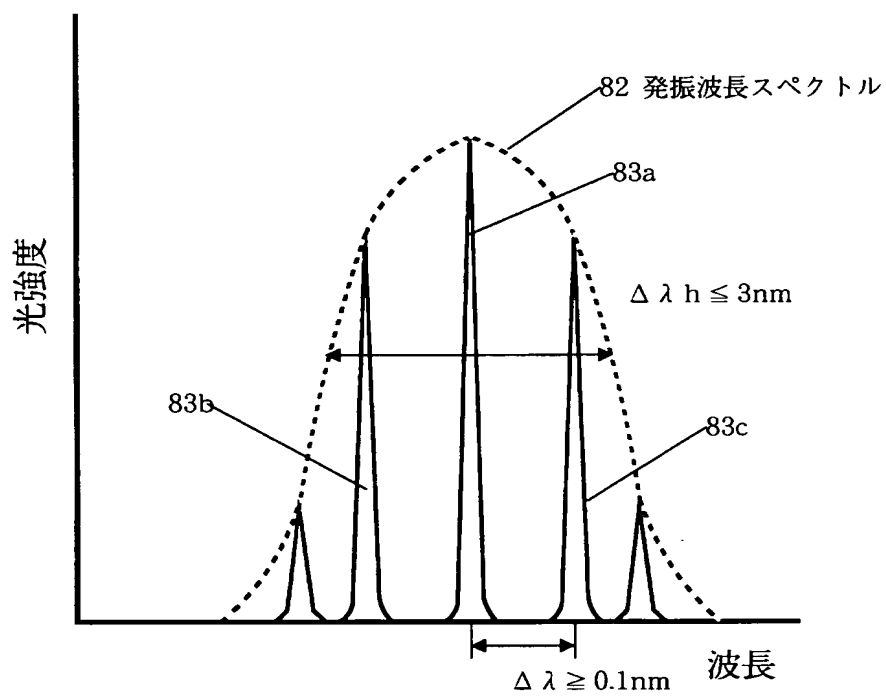
【図 14】



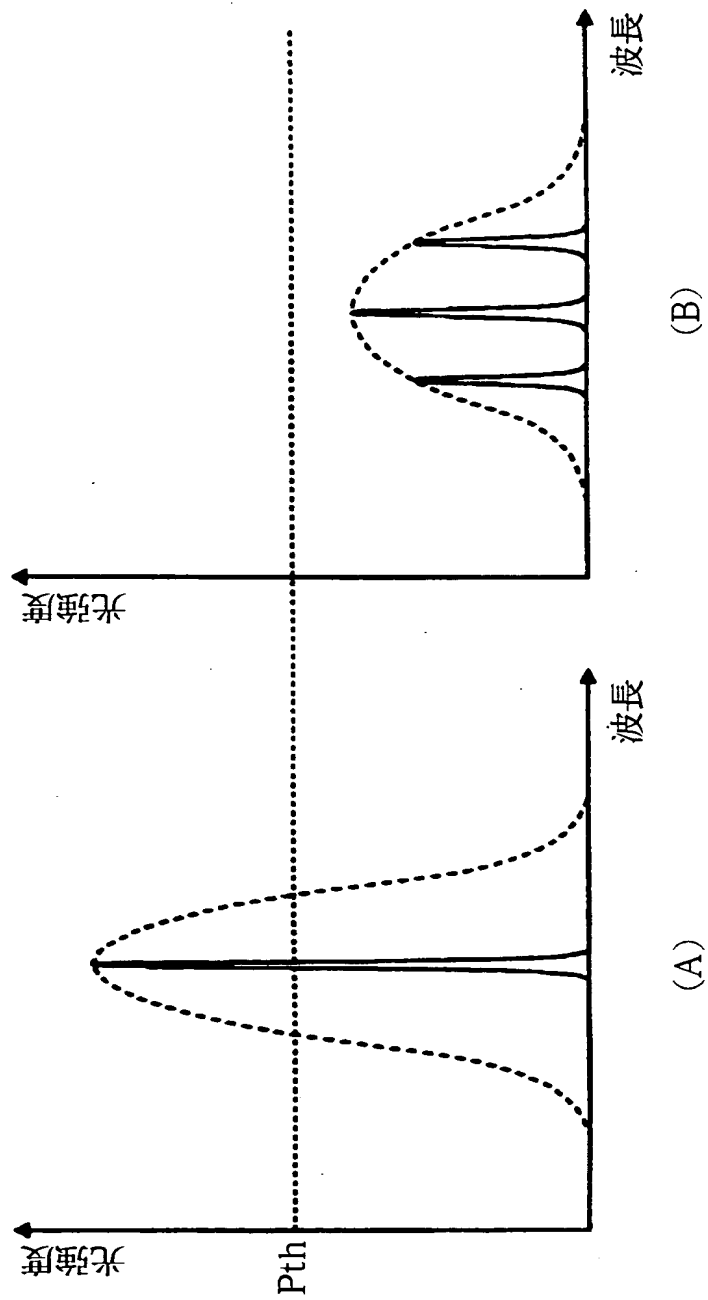
【図 15】



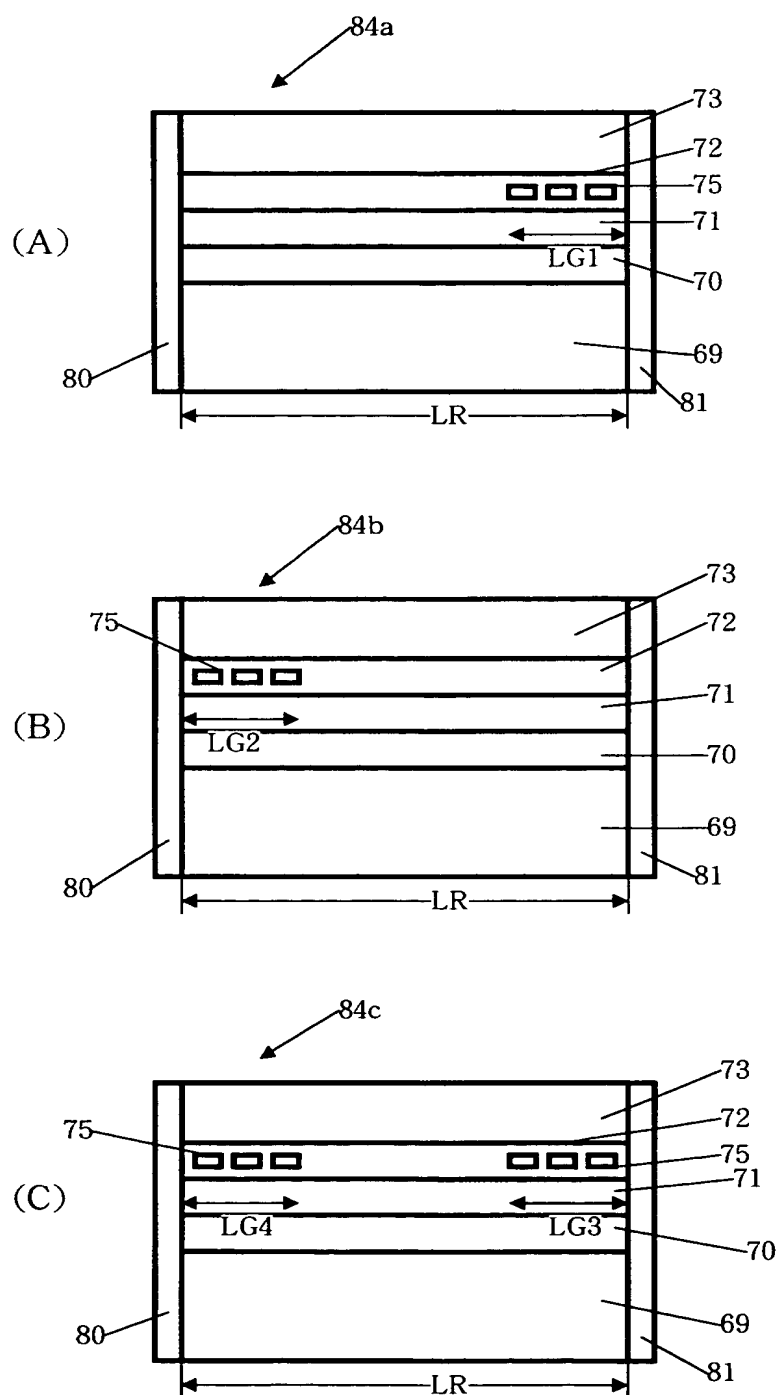
【図 16】



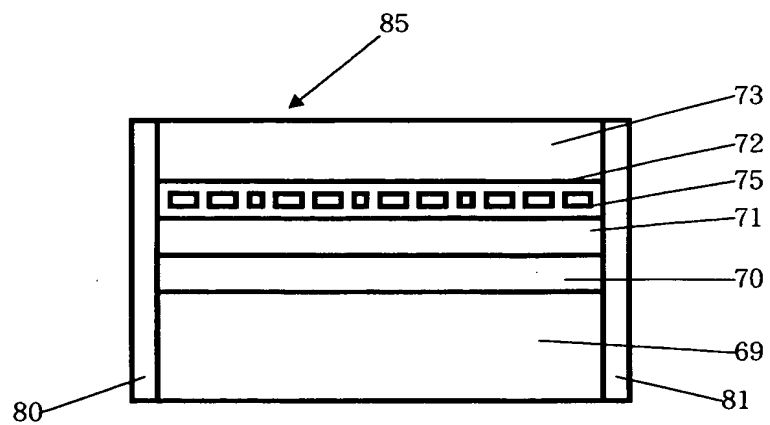
【図 17】



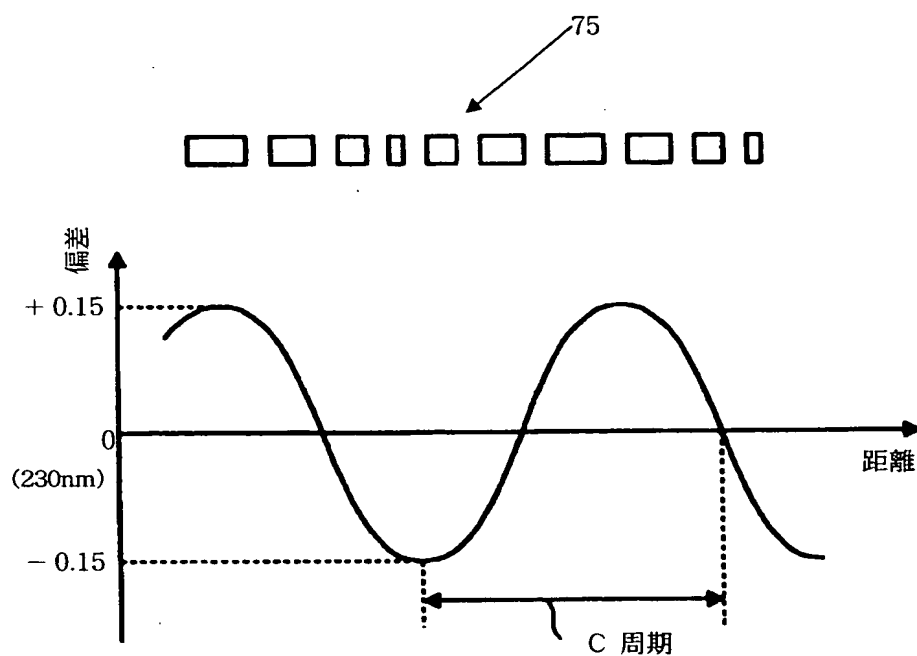
【図 18】



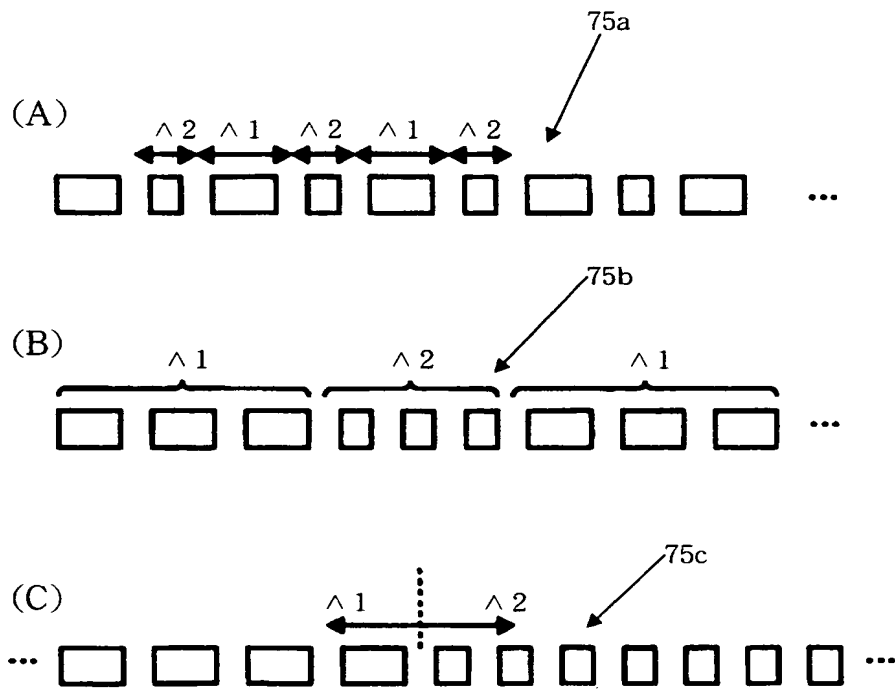
【図 19】



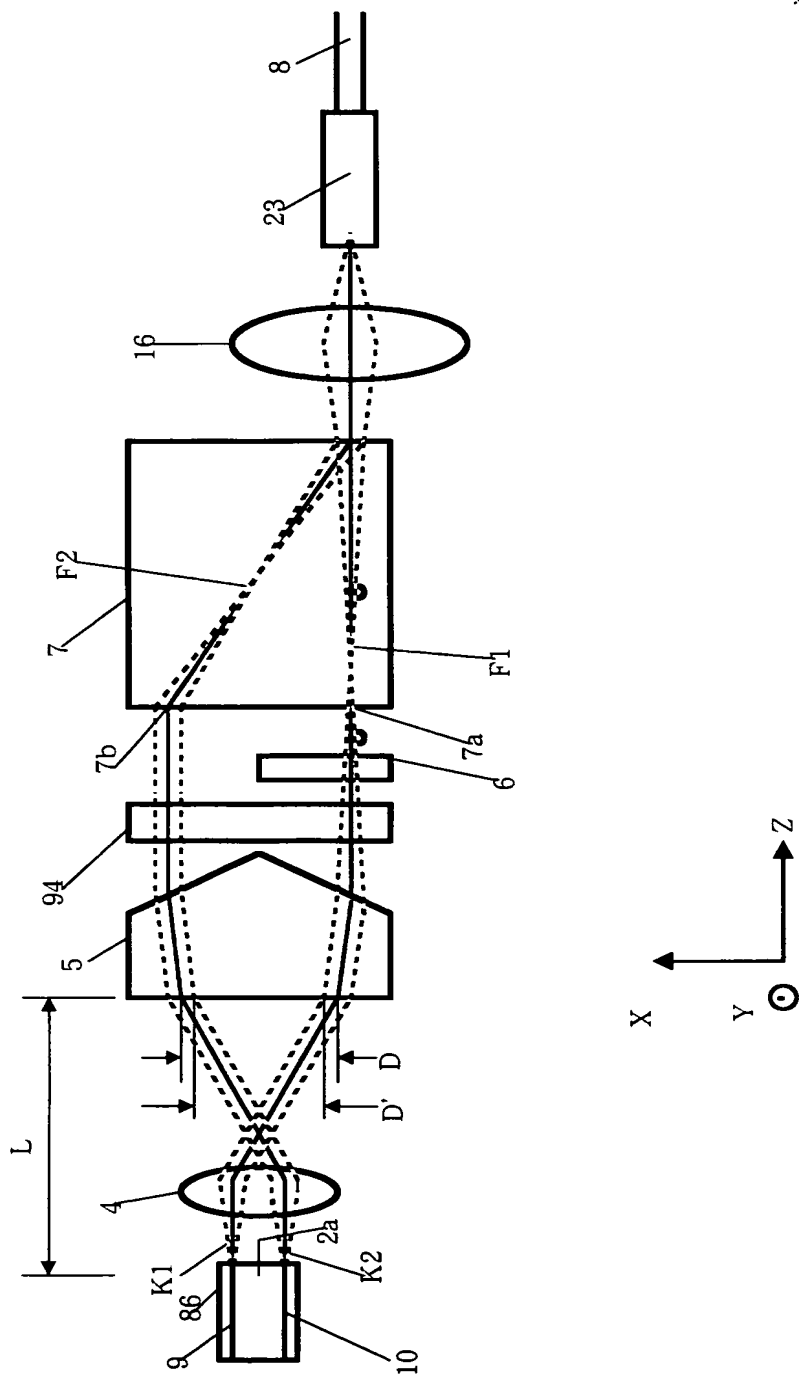
【図 20】



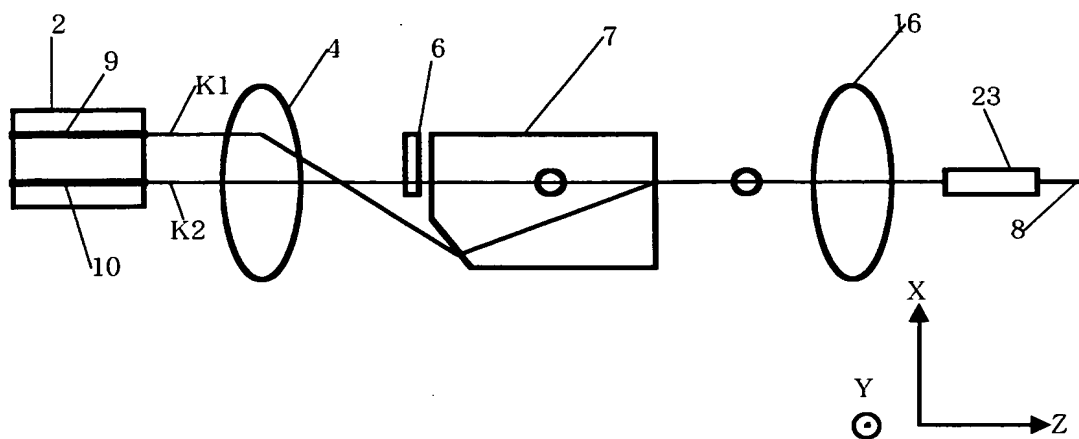
【図 21】



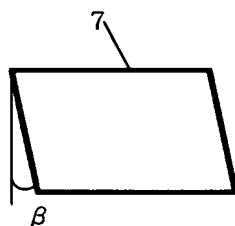
【図 22】



【図 23】

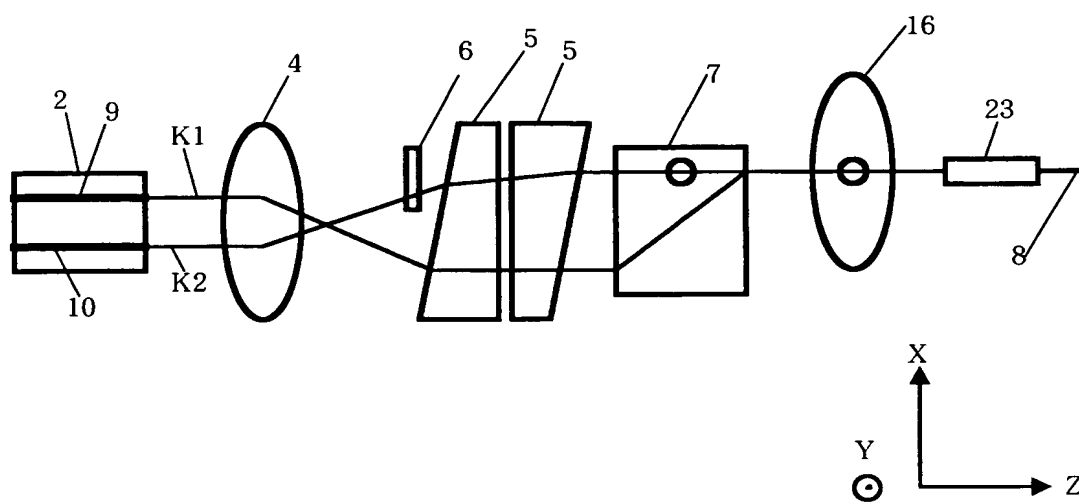


(A)

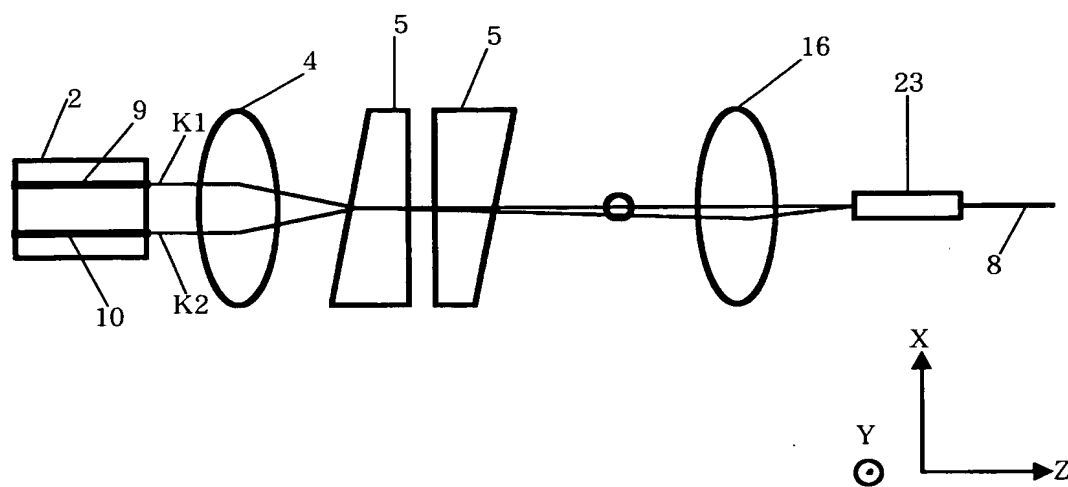


(B)

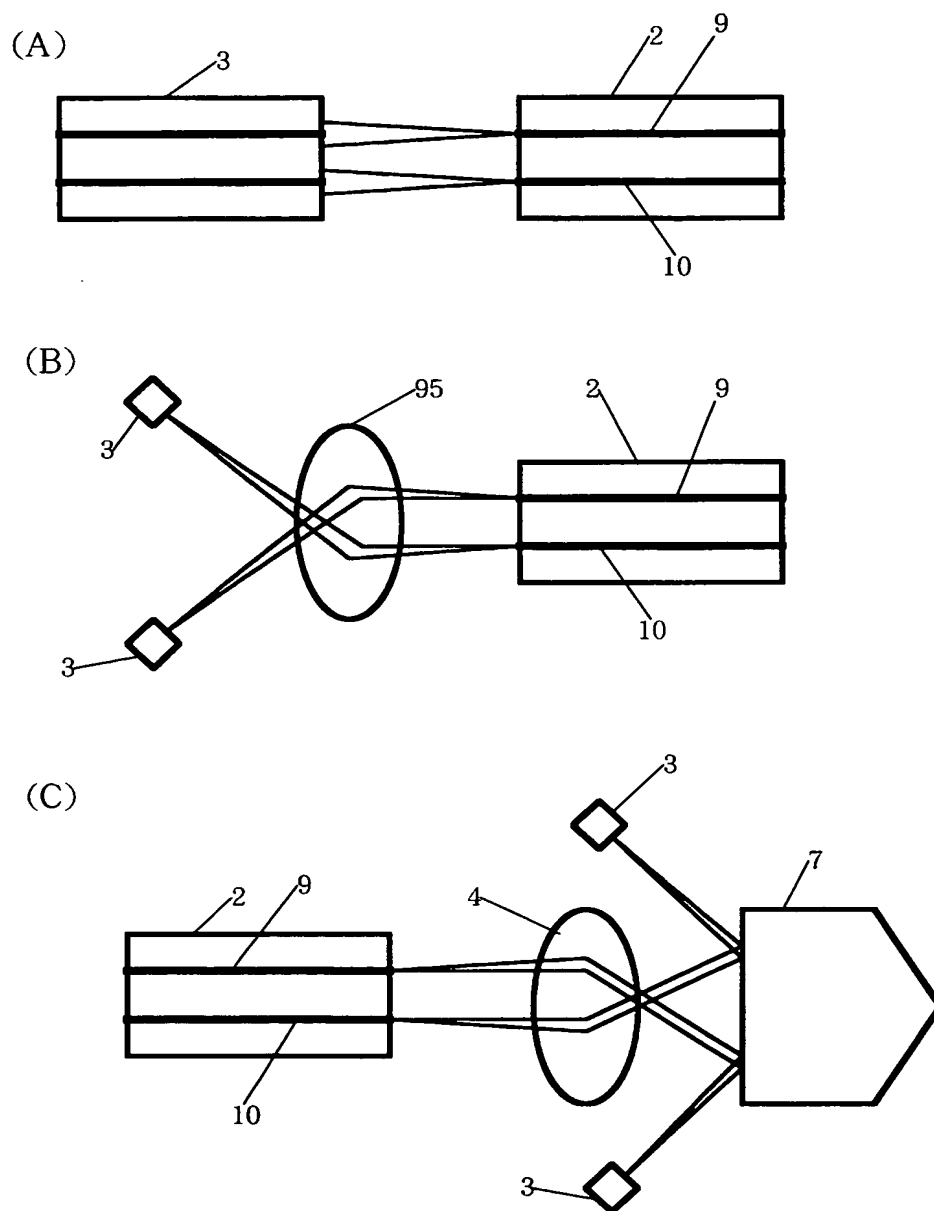
【図 24】



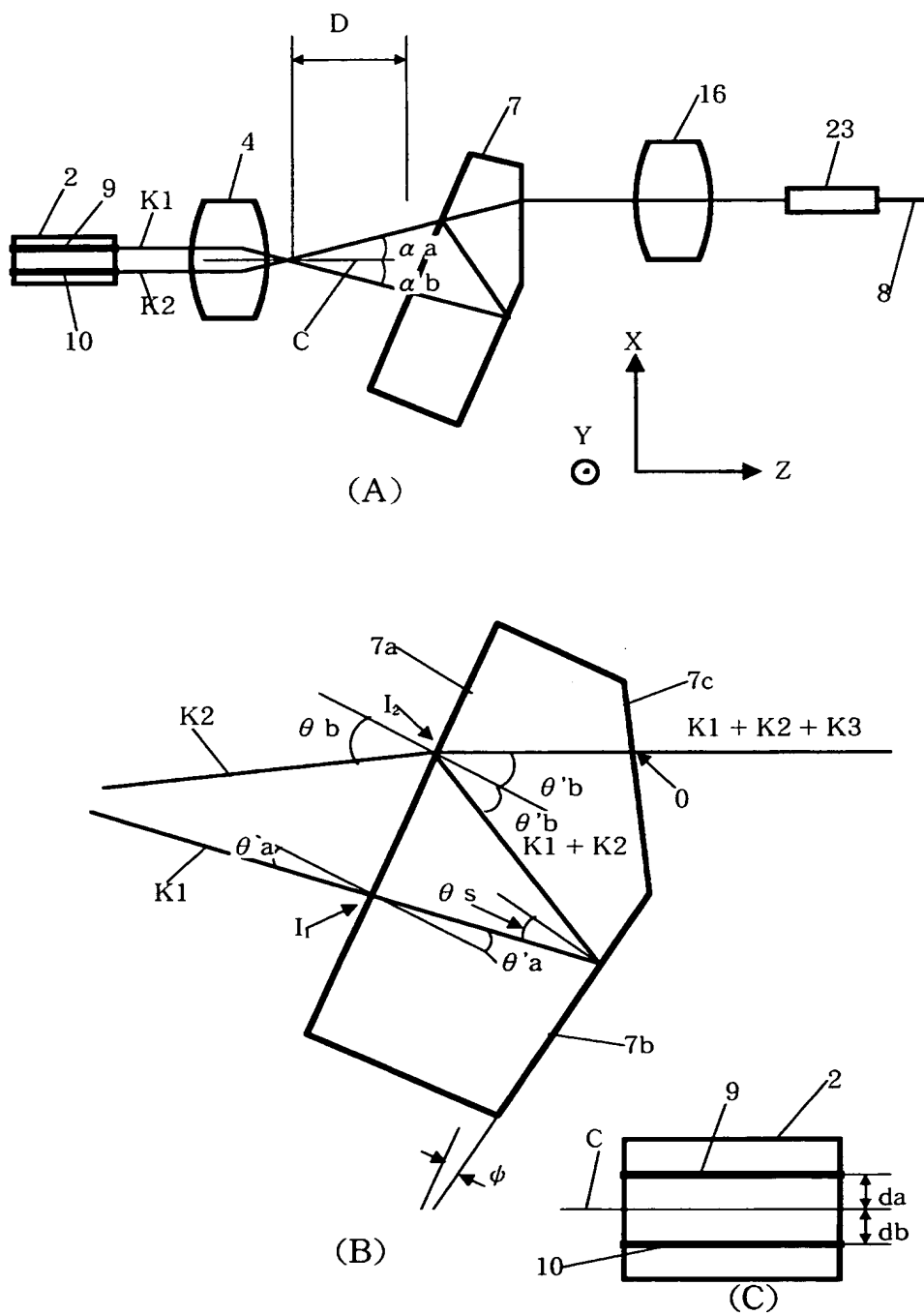
【図 25】



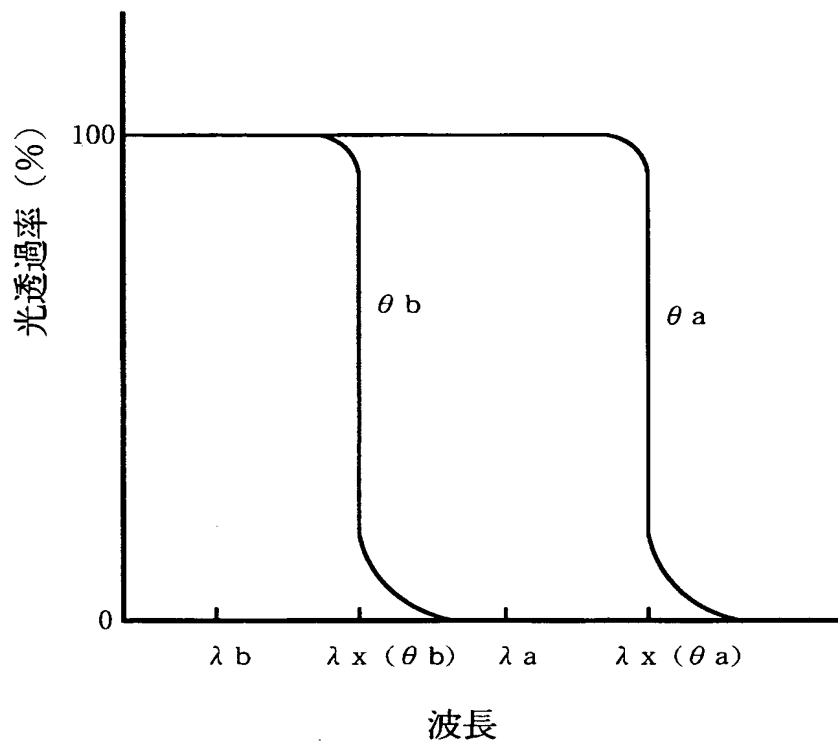
【図 26】



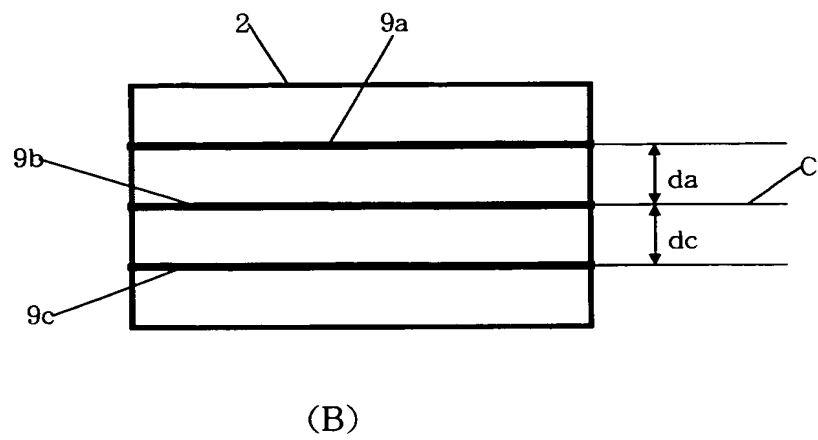
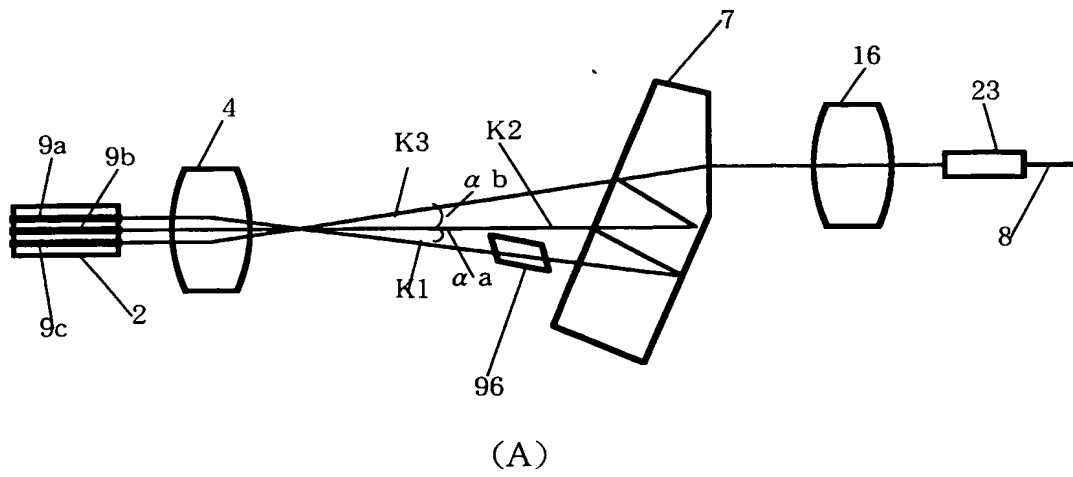
【図 27】



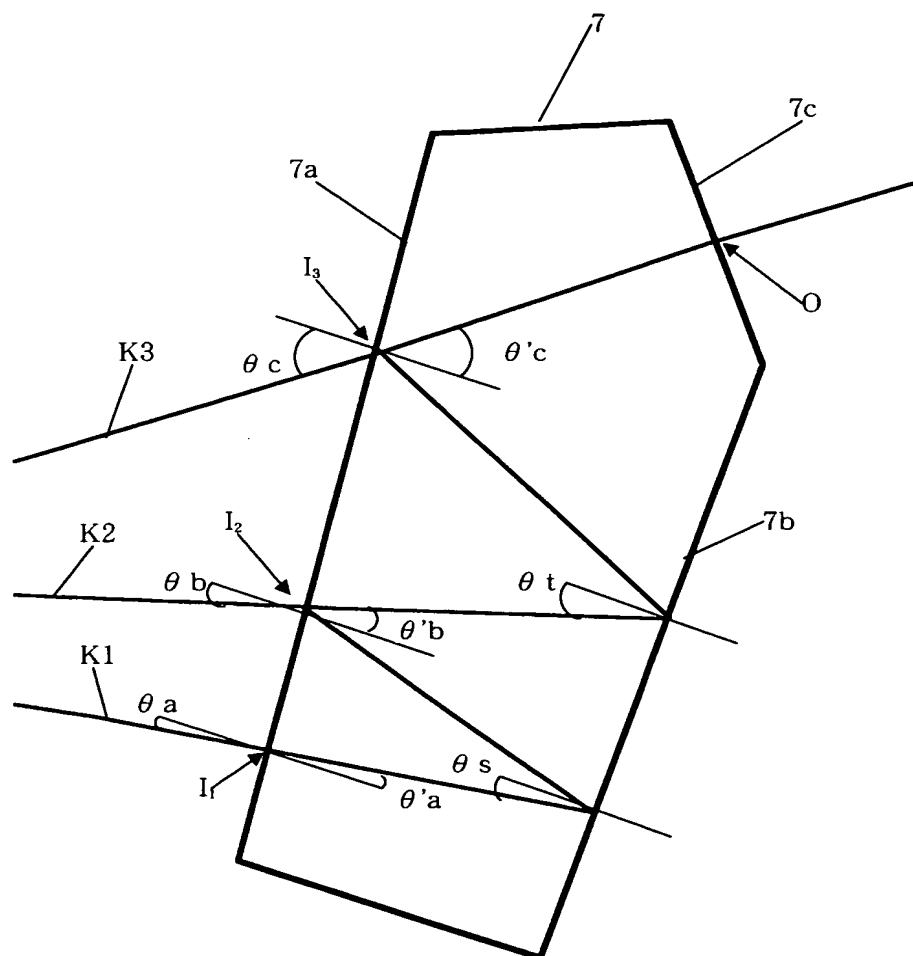
【図 28】



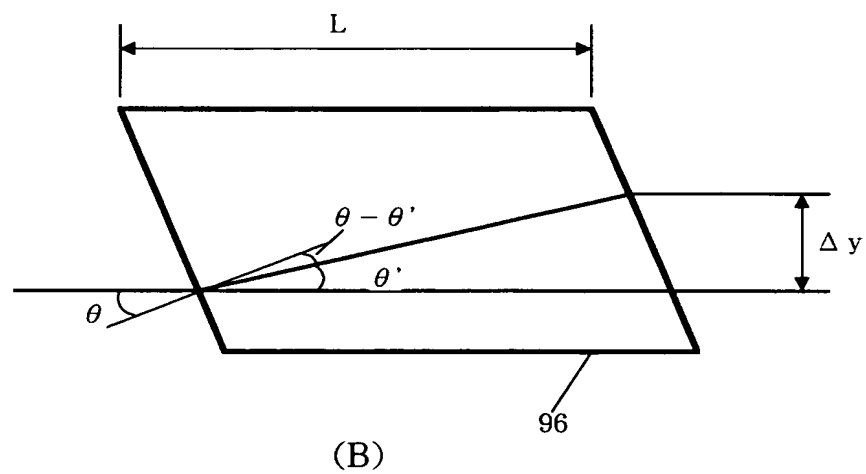
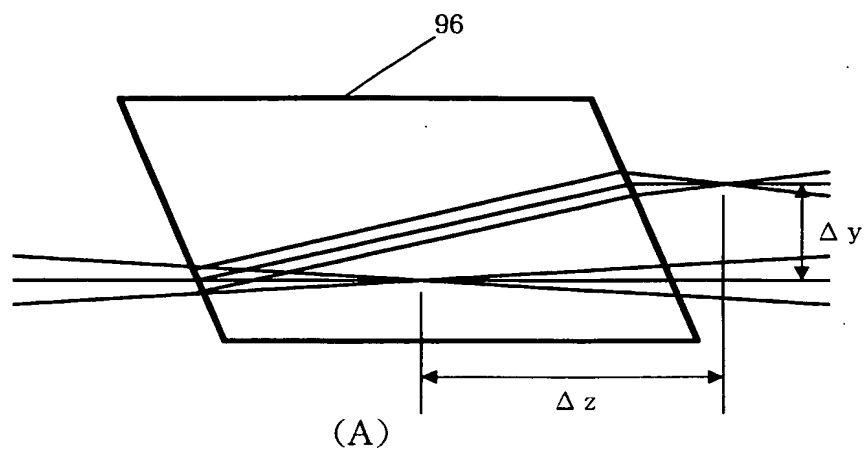
【図 29】



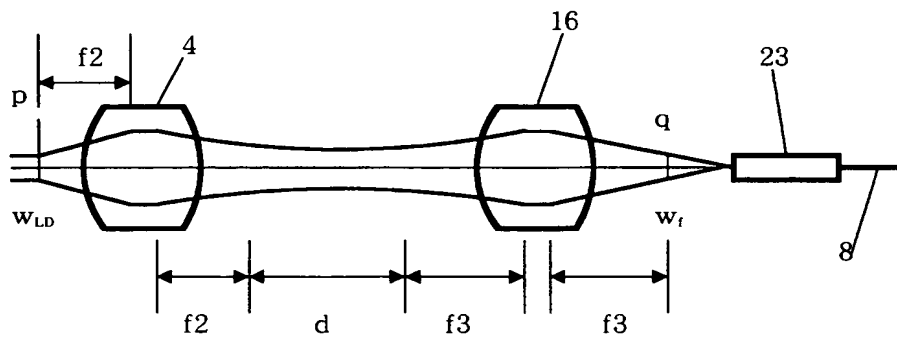
【図 30】



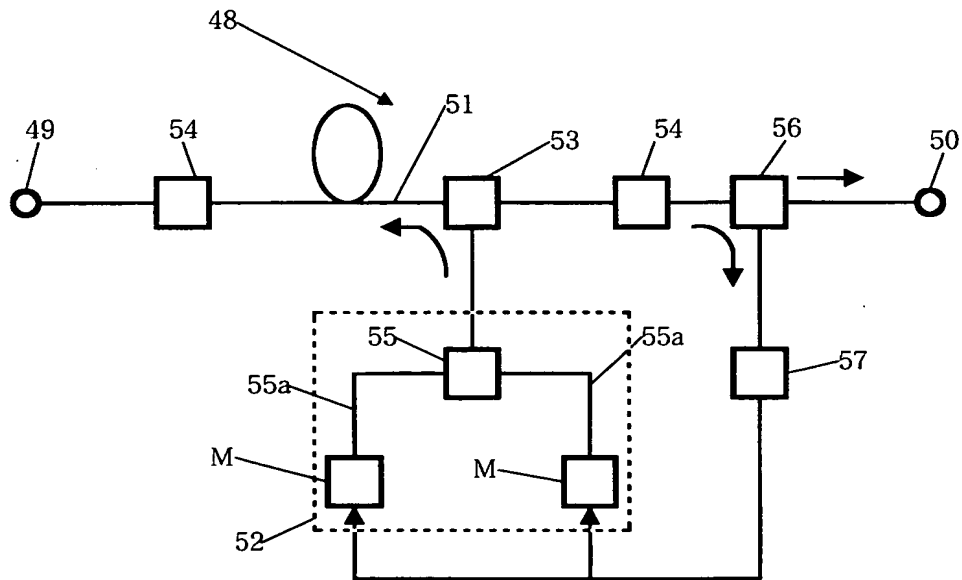
【図 31】



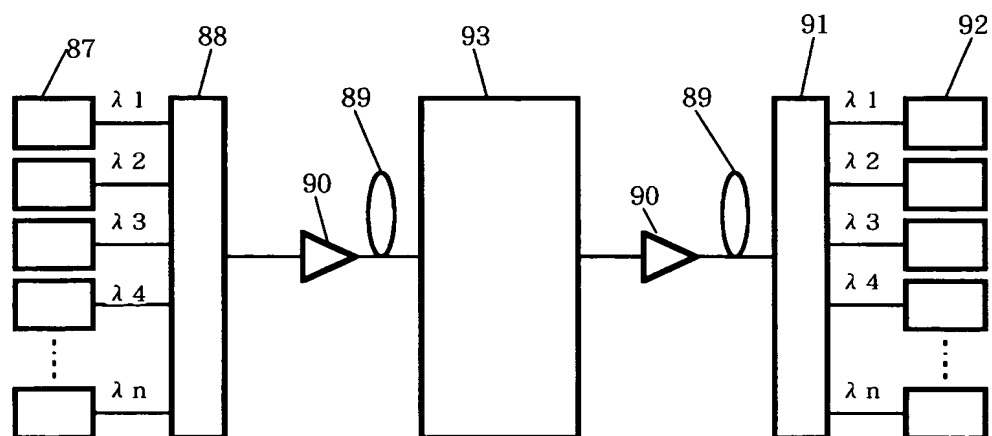
【図 32】



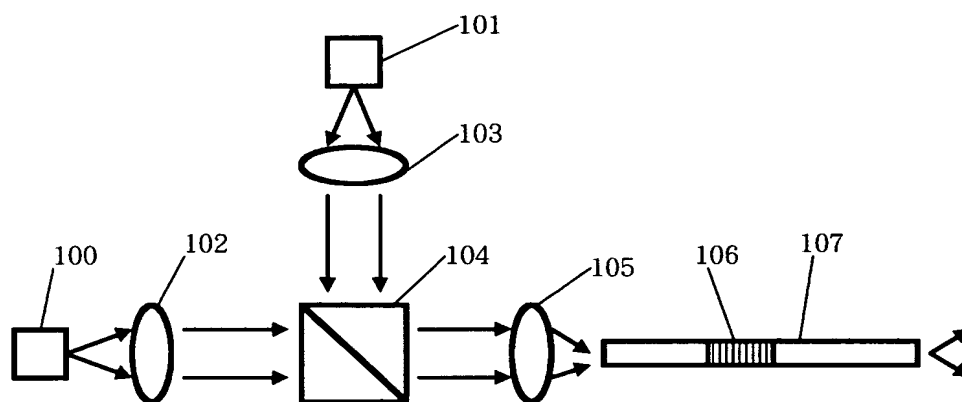
【図 33】



【図 34】



【図 35】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

安定し、高利得を得ることができる光増幅器用光源等に適した半導体レーザモジュール及びその半導体レーザモジュールを用いた光増幅器を提供する。

【解決手段】

間隔を隔てて形成された第1のストライプ9及び第2のストライプ10を有し、第1のストライプ9及び第2のストライプ10の端面からそれぞれ第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2を出射し、各ストライプ9, 10に回折格子が設けられている半導体レーザ素子86と、半導体レーザ素子2から出射された第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2とが入射され、第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2とを別焦点に集光させる第1レンズ4と、第1のレーザ光K1の偏波面を90度回転させる半波長板6と、入射された第1のレーザ光K1と第2のレーザ光K2とが合波されて出射される偏波合成部材7と、偏波合成部材7から出射されるレーザ光を受光し外部に送出する光ファイバ8と、を有する。

【選択図】 図22

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成13年 8月29日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
 【出願番号】 特願2001-201513
【補正をする者】
 【識別番号】 000005290
 【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100096035
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 中澤 昭彦

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 築地 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 吉田 順自

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 舟橋 政樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 木村 俊雄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 愛清 武

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 清水 健男

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 山本 敏郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 虎谷 智明

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 松浦 寛

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 小西 美恵子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 中江 将士

【その他】 発明者の「舟橋 政樹」を「船橋 政樹」と誤記で出願されていたので、訂正する。

【プルーフの要否】 要

特願 2 0 0 1 - 2 0 1 5 1 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 2 9 0]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 9 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号
氏 名	古河電気工業株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.